

(19) 日本国特許庁(JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02011/043339

発行日 平成25年3月4日 (2013.3.4)

(43) 国際公開日 平成23年4月14日 (2011.4.14)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
<b>HO 1 L 27/146 (2006.01)</b>	HO 1 L 27/14 A	4 M 1 1 8
<b>HO 4 N 5/374 (2011.01)</b>	HO 4 N 5/335 7 4 0	5 C 0 2 4
<b>HO 4 N 5/369 (2011.01)</b>	HO 4 N 5/335 6 9 0	

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 30 頁)

出願番号 特願2011-535400 (P2011-535400)	(71) 出願人 304023318 国立大学法人静岡大学 静岡県静岡市駿河区大谷836
(21) 国際出願番号 PCT/JP2010/067452	
(22) 国際出願日 平成22年10月5日 (2010.10.5)	
(31) 優先権主張番号 特願2009-231587 (P2009-231587)	(74) 代理人 100083806 弁理士 三好 秀和
(32) 優先日 平成21年10月5日 (2009.10.5)	(74) 代理人 100108914 弁理士 鈴木 壯兵衛
(33) 優先権主張国 日本国 (JP)	(72) 発明者 川人 祥二 静岡県浜松市中区城北3丁目5-1 国立 大学法人静岡大学 電子工学研究所内
	(72) 発明者 澤田 友成 静岡県浜松市中区城北3丁目5-1 国立 大学法人静岡大学 電子工学研究所内

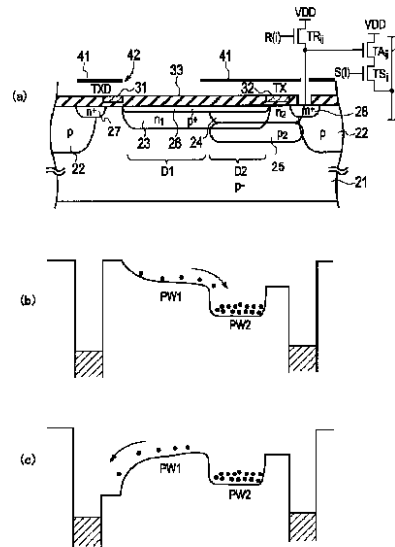
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体素子及び固体撮像装置

(57) 【要約】

電荷の転送効率が良く、画素の構造が簡単で高解像度化及び高速動作が可能な固体撮像装置を提供する。p型の半導体領域(21)と、半導体領域(21)とフォトダイオードをなすn型の埋込領域(23)と、埋込領域(23)からフォトダイオードが生成した電荷を排出する、埋込領域(23)よりも高不純物密度でn型の排出領域27と、電荷の非排出時に電荷を埋込領域(23)から転送され蓄積する、埋込領域(23)よりも高不純物密度でn型の読み出し領域(28)と、埋込領域(23)から読み出し領域(28)へ至るポテンシャルプロファイルの電位勾配、及び埋込領域(23)から排出領域27へ至るポテンシャルプロファイルの電位勾配を変化させ、電荷の転送及び排出を制御する電位勾配変更手段(31, 32)とを備える。

[図3]



## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

第 1 導電型の半導体領域と、

前記半導体領域の上部の一部に埋め込まれ、前記半導体領域とフォトダイオードをなす第 2 導電型の埋込領域と、

前記埋込領域から離間して前記半導体領域の一部に設けられ、特定のタイミングにおいて前記埋込領域から前記フォトダイオードが生成した電荷を排出する、前記埋込領域よりも高不純物密度で第 2 導電型の排出領域と、

前記半導体領域の一部に設けられ、前記電荷の非排出時に前記電荷を前記埋込領域から転送され、読み出されるまで蓄積する、前記埋込領域よりも高不純物密度で第 2 導電型の読み出し領域と、

前記埋込領域と前記排出領域との間の前記半導体領域からなるチャネルの上部に設けられ、前記チャネルの電位を制御して、前記埋込領域から前記読み出し領域へ至るポテンシャルプロファイルの少なくとも一部の電位勾配、及び前記埋込領域から前記排出領域へ至るポテンシャルプロファイルの電位勾配を変化させ、前記電荷の転送の少なくとも一部及び前記電荷の排出を制御する電位勾配変更手段

とを備えることを特徴とする半導体素子。

## 【請求項 2】

前記読み出し領域が、前記埋込領域から離間して前記半導体領域の一部に設けられ、

前記埋込領域から前記読み出し領域に至る経路の一部の前記埋込領域側に設けられ、前記埋込領域の多数キャリアに対する前記埋込領域がなすポテンシャル谷の底の電位よりも深く、前記読み出し領域がなす前記多数キャリアに対するポテンシャル井戸の深さよりも浅いポテンシャル谷を形成する第 2 導電型の蓄積領域を更に備え、

前記電荷の転送時において、前記埋込領域から前記蓄積領域へ向かい次第に電位が下がる電位勾配を形成し、前記電荷を前記埋込領域から前記蓄積領域へ転送することを特徴とする請求項 1 に記載の半導体素子。

## 【請求項 3】

前記読み出し領域が、前記埋込領域の内部、前記埋込領域と連続、又は前記埋込領域と少なくとも一部を重複して設けられ、

前記読み出し領域を囲んで前記読み出し領域に連続して設けられ、前記埋込領域の多数キャリアに対する前記埋込領域がなすポテンシャル谷の底の電位よりも深く、前記読み出し領域がなす前記多数キャリアに対するポテンシャル井戸の深さよりも浅いポテンシャル谷を形成する第 2 導電型の蓄積領域を更に備え、

前記電荷の転送時において、前記埋込領域から前記蓄積領域へ向かい次第に電位が下がる電位勾配を形成し、前記電荷を前記埋込領域から前記蓄積領域へ転送することを特徴とする請求項 1 に記載の半導体素子。

## 【請求項 4】

前記蓄積領域が前記埋込領域よりも高不純物密度であることを特徴とする請求項 2 又は 3 に記載の半導体素子。

## 【請求項 5】

前記読み出し領域が、前記埋込領域の内部、前記埋込領域と連続、又は前記埋込領域と少なくとも一部を重複して設けられ、

前記電荷の転送時に、前記埋込領域から前記蓄積領域へ向かい次第に電位が下がる電位勾配に沿って、前記電荷が前記埋込領域から前記蓄積領域へ直接転送されることを特徴とする請求項 1 に記載の半導体素子。

## 【請求項 6】

前記電荷が前記埋込領域から排出されるとき、電荷流入面の主面となる排出領域の端部が、平面パターン上前記埋込領域の端部と平行に対峙していることを特徴とする請求項 1 ~ 5 のいずれか 1 項に記載の半導体素子。

## 【請求項 7】

10

20

30

40

50

前記蓄積領域の下方に、第 1 導電型で前記半導体領域よりも高不純物密度のブロック層を更に備えることを特徴とする請求項 2 ~ 5 のいずれか 1 項に記載の半導体素子。

【請求項 8】

前記排出領域の一部と前記蓄積領域の周囲を少なくとも囲む第 1 導電型のウェル領域を更に備え、

前記読み出し領域の少なくとも一部が、平面パターン上、前記ウェル領域の内部に含まれことを特徴とする請求項 5 に記載の半導体素子。

【請求項 9】

第 1 導電型の半導体領域と、

前記半導体領域の上部の一部に埋め込まれ、前記半導体領域とフォトダイオードをなす第 2 導電型の埋込領域と、

前記埋込領域から離間して前記半導体領域の一部に設けられ、特定のタイミングにおいて前記埋込領域から前記フォトダイオードが生成した電荷を排出する、前記埋込領域よりも高不純物密度で第 2 導電型の排出領域と、

前記半導体領域の一部に設けられ、前記電荷の非排出時に前記電荷を前記埋込領域から転送され、読み出されるまで蓄積する、前記埋込領域よりも高不純物密度で第 2 導電型の読み出し領域と、

前記埋込領域と前記排出領域との間の前記半導体領域からなるチャンネルの上部に設けられ、前記チャンネルの電位を制御して、前記埋込領域から前記読み出し領域へ至るポテンシャルプロファイルの少なくとも一部の電位勾配、及び前記埋込領域から前記排出領域へ至るポテンシャルプロファイルの電位勾配を変化させ、前記電荷の転送の少なくとも一部及び前記電荷の排出を制御する電位勾配変更手段

とを備える画素を複数配列したことを特徴とする固体撮像装置。

【請求項 10】

前記読み出し領域が、前記埋込領域から離間して前記半導体領域の一部に設けられ、

前記埋込領域から前記読み出し領域に至る経路の一部の前記埋込領域側に設けられ、前記埋込領域の多数キャリアに対する前記埋込領域がなすポテンシャル谷の底の電位よりも深く、前記読み出し領域がなす前記多数キャリアに対するポテンシャル井戸の深さよりも浅いポテンシャル谷を形成する第 2 導電型の蓄積領域を更に備え、

前記電荷の転送時において、前記埋込領域から前記蓄積領域へ向かい次第に電位が下がる電位勾配を形成し、前記電荷を前記埋込領域から前記蓄積領域へ転送することを特徴とする請求項 9 に記載の固体撮像装置。

【請求項 11】

前記読み出し領域が、前記埋込領域の内部、前記埋込領域と連続、又は前記埋込領域と少なくとも一部を重複して設けられ、

前記読み出し領域を囲んで前記読み出し領域に連続して設けられ、前記埋込領域の多数キャリアに対する前記埋込領域がなすポテンシャル谷の底の電位よりも深く、前記読み出し領域がなす前記多数キャリアに対するポテンシャル井戸の深さよりも浅いポテンシャル谷を形成する第 2 導電型の蓄積領域を更に備え、

前記電荷の転送時において、前記埋込領域から前記蓄積領域へ向かい次第に電位が下がる電位勾配を形成し、前記電荷を前記埋込領域から前記蓄積領域へ転送することを特徴とする請求項 9 に記載の固体撮像装置。

【請求項 12】

前記蓄積領域が前記埋込領域よりも高不純物密度であることを特徴とする請求項 10 又は 11 に記載の固体撮像装置。

【請求項 13】

前記読み出し領域が、前記埋込領域の内部、前記埋込領域と連続、又は前記埋込領域と少なくとも一部を重複して設けられ、

前記電荷の転送時に、前記埋込領域から前記蓄積領域へ向かい次第に電位が下がる電位勾配に沿って、前記電荷が前記埋込領域から前記蓄積領域へ直接転送されることを特徴と

10

20

30

40

50

する請求項 9 に記載の固体撮像装置。

【請求項 14】

前記電荷が前記埋込領域から排出されるとき、電荷流入面の主面となる排出領域の端部が、平面パターン上前記埋込領域の端部と平行に対峙していることを特徴とする請求項 9 ~ 13 のいずれか 1 項に記載の固体撮像装置。

【請求項 15】

前記蓄積領域の下方に、第 1 導電型で前記半導体領域よりも高不純物密度のブロック層を更に備えることを特徴とする請求項 10 ~ 13 のいずれか 1 項に記載の固体撮像装置。

【請求項 16】

前記排出領域の一部と前記蓄積領域の周囲を少なくとも囲む第 1 導電型のウェル領域を更に備え、

前記読み出し領域の少なくとも一部が、平面パターン上、前記ウェル領域の内部に含まれことを特徴とする請求項 13 に記載の固体撮像装置。

【請求項 17】

前記読み出し領域が、前記画素にそれぞれ設けられた読み出しトランジスタのゲート電極に接続されることを特徴とする請求項 10 ~ 16 のいずれか 1 項に記載の固体撮像装置。

【請求項 18】

前記読み出し領域が、前記リセットトランジスタのソース電極をなす、又は前記ソース電極に接続されることを特徴とする請求項 17 に記載の固体撮像装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は光が生成した電子の検出を時間領域で変調する機能を持った半導体素子、及びこの半導体素子を 1 次元又は 2 次元配列した固体撮像装置に関する。

【背景技術】

【0002】

1994年に発表された「強度変調された照射野の検出及び復調のための装置（特許文献1参照。）」等の画素内に光で発生した電子の検出を時間領域で変調する機能を持ったセンサ要素は、「ロックインピクセル」とも呼ばれる。この様なロックインピクセルからなるセンサ要素を、最近のCMOSイメージセンサに用いられている埋込フォトダイオード構造に適用して、ロックインイメージセンサを実現することができれば、量産性に優れるため、安価で高性能なセンサが得られると期待される。

【0003】

例えば、CMOS製造技術を用いて共通のIC上に形成されたピクセル光検知ディテクタ及び専用の電子回路及び対応する処理回路の2次元アレイを含んだ3次元画像化システムが提案されている（特許文献2参照。）。特許文献1の1つの実施例においては、各ディテクタは、システムによって放射され、物体の点から反射され、そしてフォーカスされたピクセルディテクタによって検出されたパルスについての飛行時間（TOF）に比例するクロックパルス数を積算する対応する高速カウンタを有している。TOFデータは、特定のピクセルから、放射された光パルスを反射する物体上の点までの距離についての直接のデジタル的な尺度を与える。特許文献2の第2実施例では、カウンタ及び高速クロック回路は設けられず、代わりに電荷蓄積器及び電子シャッタ（S1）が各ピクセルディテクタに設けられる。各ピクセルディテクタは電荷を蓄積し、その総量が往復のTOFの直接的な尺度を与える。

しかしながら、従来のロックインピクセルを用いたイメージセンサは、いずれもMOSトランジスタのゲート構造を介して、電荷を1つ以上の蓄積領域に転送する動作を、変調された光と同期して検出するものである。このため、従来のロックインピクセルを用いたイメージセンサは構造が複雑であり、又MOSトランジスタのゲート構造を介した転送の場合、シリコン（Si）とシリコン酸化膜（SiO<sub>2</sub>）の界面のトラップに電子が捕獲さ

10

20

30

40

50

れ、転送遅れが生じるという問題も発生する。

【0004】

このため、本発明者の一人は固体撮像装置のそれぞれの画素として機能する半導体素子が、光を入射するn型の受光用表面埋込領域と、平面パターン上、受光用表面埋込領域と一部重複する位置に埋め込まれ、受光用表面埋込領域よりもポテンシャル井戸（電子井戸）の深さが深く、受光用表面埋込領域が生成した電荷を蓄積するn型の電荷蓄積領域と、電荷蓄積領域が蓄積した電荷を受け入れるn型の電荷読み出し領域と、受光用表面埋込領域が生成した電子を排出するように、平面パターン上、受光用表面埋込領域の両側にそれぞれ配置されたn型の第1及び第2の排出ドレイン領域とを備える構造を提案した（特許文献3参照。）。ここで、受光用表面埋込領域と第1及び第2の排出ドレイン領域は、p型

10

【0005】

特許文献3で提案した構造においては、電荷蓄積領域と電荷読み出し領域との間に、電荷蓄積領域から電荷読み出し領域へ電荷を転送する読み出しゲート電極が配置され、読み出しゲート電極がゲート絶縁膜を介して電荷蓄積領域と電荷読み出し領域との間に形成される転送チャンネルの電位を制御し、電荷蓄積領域から電荷読み出し領域へ電荷を転送する。ゲート絶縁膜と、ゲート絶縁膜上の第1及び第2の排出ゲート電極とで、受光用表面埋込領域と第1の排出ドレイン領域の間の半導体領域の上部及び受光用表面埋込領域と第2の排出ドレイン領域の間の半導体領域の上部に形成されるチャンネルの電位をそれぞれ制御して、受光用表面埋込領域から第1及び第2の排出ドレイン領域へそれぞれ電荷を排出する。

20

【0006】

特許文献3で提案した構造によれば、受光用表面埋込領域と電荷蓄積領域の間にゲート構造を設けなくても、第1及び第2の排出ゲート電極に印加する電圧によりポテンシャル形状を変化させることにより、受光用表面埋込領域から電荷蓄積領域への電荷の転送を制御することができる。

30

【先行技術文献】

【特許文献】

【0007】

【特許文献1】特表平10-508736号公報

【特許文献2】特表2003-510561号公報

【特許文献3】国際公開W02010/074252号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

40

【0008】

特許文献3で提案した半導体素子においては、電荷転送経路のポテンシャル分布（ポテンシャル形状）を静電誘導効果により制御して、第1及び第2の排出ゲート電極による電子の転送方向の変調を実現しているが、受光用表面埋込領域の両側に排出ゲート電極があると、構造が複雑になるばかりか、電荷転送経路の中心付近でポテンシャル傾斜が0になってしまう、電荷の一部が残ってしまう可能性があり、効率よく電荷を転送できないという不具合があった。

【0009】

本発明は、以上を鑑みて発案されたものであり、電荷の通路の中心付近でポテンシャル傾斜が0になってしまう不都合を解消して、電荷転送経路の全幅においてポテンシャル傾

50

斜を生じさせることにより、電荷の転送効率が良く、画素の構造が簡単で高解像度化及び高速動作が可能な固体撮像装置及びこの固体撮像装置のセンサ要素（画素）として用いることの可能な半導体素子を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0010】

上記目的を達成するために、本発明の第1の態様は、(a)第1導電型の半導体領域と、(b)半導体領域の上部の一部に埋め込まれ、半導体領域とフォトダイオードをなす第2導電型の埋込領域と、(c)埋込領域から離間して半導体領域の一部に設けられ、特定のタイミングにおいて埋込領域からフォトダイオードが生成した電荷を排出する、埋込領域よりも高不純物密度で第2導電型の排出領域と、(d)半導体領域の一部に設けられ、電荷の非排出時に電荷を埋込領域から転送され、読み出されるまで蓄積する、埋込領域よりも高不純物密度で第2導電型の読み出し領域と、(e)埋込領域と排出領域との間の半導体領域からなるチャンネルの上部に設けられ、チャンネルの電位を制御して、埋込領域から読み出し領域へ至るポテンシャルプロファイルの少なくとも一部の電位勾配、及び埋込領域から排出領域へ至るポテンシャルプロファイルの電位勾配を変化させ、電荷の転送の少なくとも一部及び電荷の排出を制御する電位勾配変更手段とを備える半導体素子であることを要旨とする。

10

【0011】

本発明の第2の態様は、第1の態様で述べた半導体素子を画素として複数配列した固体撮像装置であることを要旨とする。

20

【発明の効果】

【0012】

本発明によれば、電荷の通路の中心付近でポテンシャル傾斜が0になってしまう不都合もなく、電荷転送経路の全幅においてポテンシャル傾斜を生じさせることができるので、電荷の転送効率が良く、画素の構造が簡単で高解像度化及び高速動作が可能な固体撮像装置及びこの固体撮像装置のセンサ要素（画素）として用いることの可能な半導体素子を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【0013】

【図1】本発明の第1の実施の形態に係る固体撮像装置（2次元イメージセンサ）の半導体チップ上のレイアウトを説明する模式的な平面図である。

30

【図2】第1の実施の形態に係る固体撮像装置の画素の一部となる半導体素子の構成を説明する概略的な平面図である。

【図3】図3(a)は、図2のA-A方向から見た模式的な断面図である。図3(b)は、電荷の蓄積領域への転送の様子を説明するポテンシャル図である。図3(c)は、電荷の排出領域への排出の様子を説明するポテンシャル図である。

【図4】第1の実施の形態に係る半導体素子の製造方法を説明する模式的な断面図である。

【図5】第1の実施の形態に係る固体撮像装置の読み出し方法を、排出ゲート電極に印加する制御信号TXDの繰り返し周期を基礎として説明するタイミングチャートである。

40

【図6】第1の実施の形態に係る固体撮像装置の読み出し方法を、1フレームについて説明するタイミングチャートである。

【図7】第1の実施の形態に係る固体撮像装置を用いて、蛍光の寿命を測定する場合のタイミング図である。

【図8】本発明の第2の実施の形態に係る固体撮像装置の画素の一部となる半導体素子の構成を説明する概略的な平面図である。

【図9】図9(a)は、図8のB-B方向から見た模式的な断面図である。図9(b)は、電荷の読み出し領域への転送の様子を説明するポテンシャル図である。図9(c)は、電荷の排出領域への排出の様子を説明するポテンシャル図である。

【図10】光源としてLED照明を背景光に対して相対的に増強させる場合のタイミング

50

図である。

【図 1 1】本発明の第 3 の実施の形態に係る固体撮像装置の画素の一部となる半導体素子の構成を説明する概略的な平面図である。

【発明を実施するための形態】

【0014】

次に、図面を参照して、本発明の第 1 ~ 第 3 の実施の形態を説明する。以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。但し、図面は模式的なものであり、厚みと平面寸法との関係、各層の厚みの比率等は現実のものとは異なることに留意すべきである。したがって、具体的な厚みや寸法は以下の説明を参酌して判断すべきものである。又、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。

10

【0015】

又、以下に示す第 1 ~ 第 3 の実施の形態は、本発明の技術的思想を具体化するための装置や方法を例示するものであって、染色した生体細胞からの蛍光や蛍光寿命を測定するバイオイメージング用固体撮像装置、或いは、各種の計測を行う時間相関イメージセンサ等の種々の固体撮像装置に適用可能である。又、本発明の技術的思想は、構成部品の材質、形状、構造、配置等を下記のものに特定するものでなく、本発明の技術的思想は、特許請求の範囲に記載された技術的範囲内において、種々の変更を加えることができる。

【0016】

(第 1 の実施の形態)

20

本発明の第 1 の実施の形態に係る固体撮像装置(2次元イメージセンサ)は、図 1 に示すように、画素アレイ部 1 と周辺回路部(2, 3, 4, 5, 6)とを同一の半導体チップ上に集積化している。画素アレイ部 1 には、2次元マトリクス状に多数の画素  $X_{ij}$  ( $i = 1 \sim m$ ;  $j = 1 \sim n$ ;  $m, n$  はそれぞれ整数である。)が配列されており、例えば、方形状の撮像領域を構成している。画素アレイ部 1 の下辺部には、画素行  $X_{11} \sim X_{1m}; \dots; X_{i1} \sim X_{im}; \dots; X_{(n-2)1} \sim X_{(n-2)m}; X_{(n-1)1} \sim X_{(n-1)m}; X_{n1} \sim X_{nm}$  方向に沿って水平走査回路 2 が設けられ、画素アレイ部の左辺部には画素列  $X_{11}, \dots, X_{i1}, \dots, X_{(n-2)1}, X_{(n-1)1}, X_{n1}; X_{12}, \dots, X_{i2}, \dots, X_{(n-2)2}, X_{(n-1)2}, X_{n2}; X_{13}, \dots, X_{i3}, \dots, X_{(n-2)3}, X_{(n-1)3}, X_{n3}; \dots; X_{1j}, \dots, X_{ij}, \dots, X_{(n-2)j}, X_{(n-1)j}, X_{nj}; \dots; X_{1m}, \dots, X_{im}, \dots, X_{(n-2)m}, X_{(n-1)m}, X_{nm}$  方向に沿って垂直走査回路 3 が設けられている。垂直走査回路 3 及び水平走査回路 2 には、タイミング発生回路 4 が接続されている。

30

【0017】

これらのタイミング発生回路及び水平走査回路 2 及び垂直走査回路 3 によって画素アレイ部内の単位画素  $X_{ij}$  が順次走査され、画素信号の読み出しや電子シャッタ動作が実行される。即ち、第 1 の実施の形態に係る固体撮像装置では、画素アレイ部を各画素行  $X_{11} \sim X_{1m}; \dots; X_{i1} \sim X_{im}; \dots; X_{(n-2)1} \sim X_{(n-2)m}; X_{(n-1)1} \sim X_{(n-1)m}; X_{n1} \sim X_{nm}$  単位で垂直方向に走査することにより、各画素行  $X_{11} \sim X_{1m}; \dots; X_{i1} \sim X_{im}; \dots; X_{(n-2)1} \sim X_{(n-2)m}; X_{(n-1)1} \sim X_{(n-1)m}; X_{n1} \sim X_{nm}$  の画素信号を各画素列  $X_{11}, \dots, X_{i1}, \dots, X_{(n-2)1}, X_{(n-1)1}, X_{n1}; X_{12}, \dots, X_{i2}, \dots, X_{(n-2)2}, X_{(n-1)2}, X_{n2}; X_{13}, \dots, X_{i3}, \dots, X_{(n-2)3}, X_{(n-1)3}, X_{n3}; \dots; X_{1j}, \dots, X_{ij}, \dots, X_{(n-2)j}, X_{(n-1)j}, X_{nj}; \dots; X_{1m}, \dots, X_{im}, \dots, X_{(n-2)m}, X_{(n-1)m}, X_{nm}$  毎に設けられた垂直信号線によって画素信号を読み出す構成となっている。

40

【0018】

第 1 の実施の形態に係る固体撮像装置のそれぞれの画素  $X_{11} \sim X_{1m}; \dots; X_{i1} \sim X_{im}; \dots; X_{(n-2)1} \sim X_{(n-2)m}; X_{(n-1)1} \sim X_{(n-1)m}; X_{n1} \sim X_{nm}$  として機能する半導体素子の平面構造の一例を、図 2 に示し、図 2 の平面図における半導体素子の A - A 方向から見たに対応する断面図を図 3 (a) に示す。図 3 (a) に示すように、画素  $X_{ij}$  の一部となる半導体素子は、第 1 導電型(p型)の半導体領域 2 1 と、半導体領域 2 1 の上部に埋め込まれ、光を入射する第 2 導電型(n型)の埋込領域(受光カソード領域) 2 3 と、半

50

導体領域 2 1 の上部の一部に埋込領域 ( 受光カソード領域 ) 2 3 と一部を重複し、且つ埋込領域 2 3 と隣接 ( 連続 ) して埋め込まれ、埋込領域 2 3 よりもポテンシャル谷 ( 電子井戸 ) の深さが深く ( 図 3 ( b ) 及び図 3 ( c ) 参照。 )、埋込領域 2 3 が生成した電荷を蓄積する第 2 導電型 (  $n^+$  型 ) の蓄積領域 2 4 と、蓄積領域 2 4 の下方に位置し、半導体領域 2 1 より高不純物密度の第 1 導電型 (  $p^+$  型 ) のブロック層 2 5 と、半導体領域 2 1 の上部の一部に蓄積領域 2 4 から右方に離間して埋め込まれ、蓄積領域 2 4 が蓄積した電荷を受け入れる第 2 導電型 (  $n^+$  型 ) の読み出し領域 2 8 と、半導体領域 2 1 の上部の一部に埋込領域 2 3 から左方に離間して埋め込まれ、埋込領域 2 3 が生成した電子を排出する第 2 導電型 (  $n^+$  型 ) の排出領域 2 7 とを備える。埋込領域 2 3 の上から蓄積領域 2 4 の上に渡り、第 1 導電型 (  $p^+$  型 ) のピニング層 2 6 が配置されている。ピニング層 2 6 は、ダーク時の表面でのキャリアの生成や信号キャリアの捕獲を抑制する層であり、ダーク電流や信号キャリアの捕獲の削減のために好ましい層として用いている。

10

#### 【 0 0 1 9 】

図 2 に破線で示したように、ピニング層 2 6、ピニング層 2 6 の下方の埋込領域 2 3、読み出し領域 2 8 と排出領域 2 7 を囲むように、半導体領域 2 1 より高不純物密度の第 1 導電型のウェル領域 (  $p$  ウェル ) 2 2 が形成されている。図 3 ( a ) では、「第 1 導電型の半導体領域」として、第 1 導電型の半導体領域 2 1 を用いる場合を例示しているが、半導体領域 2 1 の代わりに、第 1 導電型 (  $p$  型 ) の半導体基板に、半導体基板よりも低不純物密度の第 1 導電型 (  $p$  型 ) のシリコンエピタキシャル成長層を形成して、エピタキシャル成長層を第 1 導電型の半導体領域として採用しても良く、第 2 導電型 (  $n$  型 ) の半導体基板に、第 1 導電型 (  $p$  型 ) のシリコンエピタキシャル成長層を形成して、エピタキシャル成長層を第 1 導電型の半導体領域として採用しても良い。第 2 導電型 (  $n$  型 ) の半導体基板に、pn 接合を形成するように、第 1 導電型 (  $p$  型 ) のエピタキシャル成長層を形成すれば、長い波長の場合光が、第 2 導電型の半導体基板深くまで浸入するが、第 2 導電型の半導体基板で発生した光によるキャリアは、pn 接合のビルトインポテンシャルによる電位障壁のため第 1 導電型のエピタキシャル成長層まで入って来られないので、第 2 導電型の半導体基板深くで発生したキャリアを積極的に捨てることができる。これによって、深い位置で発生したキャリアが拡散で戻ってきて、隣の画素に漏れ込むのを防ぐことが可能になる。これは特に、RGB のカラーフィルタが搭載された単板カラーのイメージセンサの場合に、色の混合を起こさないようにできる効果を奏する。

20

30

#### 【 0 0 2 0 】

埋込領域 2 3 と、埋込領域 2 3 の直下の半導体領域 ( アノード領域 ) 2 1 とで第 1 の埋込フォトダイオード ( 以下において、単に「フォトダイオード」という。 ) D 1 を構成している。蓄積領域 ( カソード領域 ) 2 4 と、蓄積領域 2 4 の直下の半導体領域 2 1 とで第 2 の埋込フォトダイオード ( 以下において「電荷蓄積ダイオード」という。 ) D 2 を構成している。

#### 【 0 0 2 1 】

ピニング層 2 6 上の半導体領域 2 1 の上、及び埋込領域 2 3 と読み出し領域 2 8 との間の半導体領域 2 1 の上にはゲート絶縁膜 3 3 が形成されている。ゲート絶縁膜 3 3 としては、シリコン酸化膜 (  $SiO_2$  膜 ) が好適であるが、シリコン酸化膜以外の種々の絶縁膜を用いた絶縁ゲート型トランジスタ ( MIS トランジスタ ) の絶縁ゲート構造をなしても良い。例えば、シリコン酸化膜 / シリコン窒化膜 (  $Si_3N_4$  膜 ) / シリコン酸化膜の 3 層積層膜からなる ONO 膜でも良い。更には、ストロンチウム ( Sr )、アルミニウム ( Al )、マグネシウム ( Mg )、イットリウム ( Y )、ハフニウム ( Hf )、ジルコニウム ( Zr )、タンタル ( Ta )、ビスマス ( Bi ) のいずれか 1 つの元素を少なくとも含む酸化物、又はこれらの元素を含むシリコン窒化物等がゲート絶縁膜 3 3 として使用可能である。

40

#### 【 0 0 2 2 】

ゲート絶縁膜 3 3 の上部には、蓄積領域 2 4 と読み出し領域 2 8 との間に形成される転送チャネルの電位を制御して、蓄積領域 2 4 から読み出し領域 2 8 へ電荷を転送する読み

50



出しゲート電極 3 2 と、埋込領域 2 3 と排出領域 2 7 との間に形成される排出チャンネルの電位を制御して、埋込領域 2 3 から、埋込領域 2 3 が生成した電子を排出領域 2 7 へ電荷を転送する排出ゲート電極 3 1 が埋込領域 2 3 の片側にのみ配置されている。ゲート絶縁膜 3 3 とゲート絶縁膜 3 3 上の排出ゲート電極 3 1 とで、埋込領域 2 3 と排出領域 2 7 との間の半導体領域 2 1 の上部に形成されるチャンネルの電位を制御し、ポテンシャルプロファイル（電位勾配）を変更して、埋込領域 2 3 から排出領域 2 7 への電荷を排出 / 非排出、及び蓄積領域 2 4 への信号電荷の転送 / 非転送を制御する電位勾配変更手段（3 1, 3 3）を構成している。又、ゲート絶縁膜 3 3 とゲート絶縁膜 3 3 上の読み出しゲート電極 3 2 とで、蓄積領域 2 4 と読み出し領域 2 8 との間の半導体領域 2 1 の上部に形成されるチャンネルの電位を制御して、蓄積領域 2 4 から読み出し領域 2 8 へ電荷を転送する電荷転送制御手段（3 2, 3 3）を構成している。

10

#### 【0023】

図 3 (b) 及び図 3 (c) は、図 3 (a) の断面図において、埋込領域 2 3、蓄積領域 2 4、読み出し領域 2 8 を水平面で切った断面におけるポテンシャル図であり、電荷（電子）を黒丸で示している。図 3 (a) に対応して、図 3 (b) 及び図 3 (c) の中央の左側に埋込領域 2 3 の伝導帯端の位置を示すポテンシャル谷（第 1 のポテンシャル谷）PW 1 を示す。更に、第 1 のポテンシャル谷 PW 1 の右側に、蓄積領域 2 4 の伝導帯端の位置を示すポテンシャル谷（第 2 のポテンシャル谷）PW 2 を示す。更に、第 2 のポテンシャル谷 PW 2 の右側に、読み出し領域 2 8 のポテンシャル井戸のフェルミレベル以下の電子が充満した状態を右上がりのハッチングで示す。読み出し領域 2 8 のポテンシャル井戸の深さは、フェルミレベルになるので、図 3 (b) 及び図 3 (c) においては、右上がりのハッチングで示した領域の上端のレベルが、ポテンシャル井戸の深さを定義する。第 2 のポテンシャル谷 PW 2 と、読み出し領域 2 8 のポテンシャル井戸との間の電位障壁は、読み出しゲート電極 3 2 直下の半導体領域 2 1 の伝導帯端のポテンシャル分布に相当する。一方、第 1 のポテンシャル谷 PW 1 の左側に、排出領域 2 7 のポテンシャル井戸のフェルミレベル以下の電子が充満した状態を右上がりのハッチングで示す。第 1 のポテンシャル谷 PW 1 と、排出領域 2 7 のポテンシャル井戸との間の電位障壁は、埋込領域 2 3 の片側にのみ設けられた排出ゲート電極 3 1 直下の半導体領域 2 1 の伝導帯端のポテンシャル分布に相当する。

20

#### 【0024】

図 3 (b) 及び図 3 (c) に示すように、埋込領域 2 3 と蓄積領域 2 4 との間にポテンシャルバリアを設けないようにして、埋込領域 2 3 の完全空乏化したときの第 1 のポテンシャル谷 PW 1 の深さが、蓄積領域 2 4 の完全空乏化したときの第 2 のポテンシャル谷 PW 2 の深さよりも階段状（ステップ状）に浅くなるようにするためには、例えば、埋込領域 2 3 の不純物密度よりも蓄積領域 2 4 の不純物密度が階段状に高くなるように、それぞれの不純物密度を選べば良い。埋込領域 2 3 の不純物密度よりも蓄積領域 2 4 の不純物密度を階段状に高く設定する方法は、公知の種々の方法が採用可能である。但し、図 2 に示した平面パターンにおけるマスク位置のずれによるポテンシャルバリアが発生しないようにするためには、図 2 及び図 3 (a) に示すように、蓄積領域 2 4 には、深い第 2 のポテンシャル谷 PW 2 を形成するように n 型の不純物が 2 回イオン注入され（不純物密度  $n_1$  と不純物密度  $n_2$ ）、浅い第 1 のポテンシャル谷 PW 1 を形成する埋込領域 2 3 には 1 回のみイオン注入される（不純物密度  $n_1$  のみ）ようにすれば良い。即ち、図 2 の平面図において埋込領域 2 3 と蓄積領域 2 4 との両方を含む広い領域への不純物密度  $n_1$  を実現するためのイオン注入のマスクと、蓄積領域 2 4 のみからなる狭い領域への不純物密度  $n_2$  のイオン注入のマスクを用意し、マスク合わせにより選択的に 1 回のみイオン注入される領域と選択的に 2 回イオン注入される領域を形成して階段状の不純物密度分布を実現すれば良い。

30

40

#### 【0025】

ブロック層 2 5 は、第 1 の実施の形態に係る固体撮像装置に使用する波長が長い場合において、半導体領域 2 1 の深くで発生した電子が表面に拡散によって戻ってくる場合、そ

50

の一部が、蓄積領域 2 4 に取り込まれるのをブロックすることができる。このため、例えば近赤外光など、使用する光の波長が長い場合であっても、排出ゲート電極 3 1 の電位制御による発生電子の蓄積領域 2 4 への転送の変調特性に対する、半導体領域 2 1 の深くで発生した電子が表面に拡散によって戻ってくる影響を抑制することが可能である。

【 0 0 2 6 】

蓄積領域 2 4 及びブロック層 2 5 は、図 4 に示すように、半導体領域 2 1 を、フォトレジスト膜でマスキングし、例えば p 型の半導体を形成するホウ素イオン ( $^{11}\text{B}^+$ )、n 型の半導体を形成する砒素イオン ( $^{75}\text{As}^+$ ) を、順次イオン注入することにより形成される。ブロック層 2 5 を形成するホウ素イオン ( $^{11}\text{B}^+$ ) は深く、蓄積領域 2 4 を形成する砒素イオン ( $^{75}\text{As}^+$ ) 等は浅く注入する。イオン注入の加速電圧が高いほど深く注入することができるが、同じ加速電圧の場合は軽い質量のホウ素の方が砒素と比べ深く注入される。蓄積領域 2 4 及びブロック層 2 5 は、1 種のマスクを用いて形成されるので、フォトレジスト膜のマスクずれによるポテンシャルバリアが形成されることを防ぐことができ、ポテンシャルバリアによる電荷の転送不良をなくし、転送を高速化できる。

10

【 0 0 2 7 】

図 2 に示す平面図において、埋込領域 2 3 は、F 字型をなすように、上側に延伸した先の 2 箇所を屈折して右側に 2 本の段付きストライプとして延伸し、2 本の段付きストライプはそれぞれ、右方に向け階段状に幅が減少している。図 2 に示すように、埋込領域 2 3 の平面パターンの一部を複数の細かい縞状 (ストライプ状) にして、互いに対峙させることにより、縞状パターンの中の半導体領域 2 1 を容易に空乏化させることができる。F 字型をなす縞状パターンにより、受光面積を拡大し、且つ第 1 のポテンシャル谷 PW 1 の底 (空乏化したときの電位) を実効的に第 2 のポテンシャル谷 PW 2 の底よりも高くすることができ、信号電荷の完全転送を行うことができる。図 2 では、F 字型をなすように、右上側に 2 本の段付きストライプを示したが例示に過ぎず、3 本以上のストライプでも構わない。図 2 において、排出ゲート電極 3 1 は、埋込領域 2 3 の左側の辺の一部と隣接するように、埋込領域 2 3 の片側にのみ配置され、排出領域 2 7 は、埋込領域 2 3 の左側に排出ゲート電極 3 1 を隔てて、排出ゲート電極 3 1 の一部から左側に突出するように隣接して設けられている。下側の部分に埋込領域 2 3 と一部を重畳し蓄積領域 2 4 及びブロック層 2 5 が設けられている。蓄積領域 2 4 とブロック層 2 5 とは同一のマスクを用いて形成されているので図 2 に示す平面図において一致している。

20

30

【 0 0 2 8 】

排出領域 2 7 と排出ゲート電極 3 1 とは、図示を省略した表面配線により互いに接続されている。埋込領域 2 3 の上にはピニング層 2 6 が形成されているので、半導体領域 2 1 の最上層に着目すれば、ピニング層 2 6 と排出領域 2 7 との間の半導体領域 2 1 の上方に排出ゲート電極 3 1 が設けられていることになる。更に、ピニング層 2 6 と読み出し領域 2 8 との間には読み出しゲート電極 3 2 が設けられている。

【 0 0 2 9 】

図 2 及び図 3 ( a ) に示すように、電荷が埋込領域 2 3 から排出されるとき、電荷流入面の主面となる排出領域 2 7 の端部が、排出ゲート電極 3 1 直下において、平面パターン上で、埋込領域 2 3 の端部と平行に対峙している。そして、埋込領域 2 3 の片側にのみ設けられた排出ゲート電極 3 1 が埋込領域 2 3 の一部に重複し且つ隣接するように配置されているので、電位勾配変更手段 ( 3 1 , 3 3 ) によって、ポテンシャルプロファイル (電位勾配) を変更する際には、埋込領域 2 3 の排出領域 2 7 に対向する部分の全体において、排出領域 2 7 に向かう電界を排出ゲート電極 3 1 直下の半導体領域 2 1 に発生させることができる。よって、第 1 の実施の形態に係る半導体素子は、電荷の排出領域 2 7 への排出効率を向上させ、且つ埋込領域 2 3 から蓄積領域 2 4 に至る信号電荷の高速転送を実現することが可能であると共に、画素の構造を簡単化できる。

40

【 0 0 3 0 】

図 2 の平面図に示すように、埋込領域 2 3 、蓄積領域 2 4 、読み出し領域 2 8 及び排出領域 2 7 を囲むように、破線で示した領域の外側に第 1 導電型のウェル領域 ( p ウェル )

50

22が形成されている。破線の更に外側のピニング層26を囲む太い実線30は、素子分離領域との境界を示す。即ち、図2に示す太い実線30の外側が、LOCOS法やSTI法等によって形成される素子分離絶縁膜の領域である。

#### 【0031】

例えば、排出領域27に接続された排出ゲート電極31に制御信号TXDとして高い電圧（正の電圧）を与えると、図3（c）に示すような埋込領域23から排出領域27の方に向かう空乏化電位の傾きが発生する。図3（c）に示すような傾きのポテンシャル分布に起因する電界によって、埋込領域23で発生した殆どの電子は排出領域27に排出され、これにより蓄積領域24には転送されなくなる。

#### 【0032】

一方、排出ゲート電極31に制御信号TXDとして低い電圧（0V、又は-1V程度の負電圧）を与えると、図3（b）に示すように、埋込領域23と排出領域27との間に電子に対する電位障壁が形成され、埋込領域23から蓄積領域24の方に向かう空乏化電位の傾きが発生する。よって、埋込領域23から排出領域27には電子は排出が止まり、図3（b）に示すようなポテンシャル分布に起因する電界によって、埋込領域23で発生した殆どの電子（電荷）が、蓄積領域24に転送される。

#### 【0033】

以上のように、埋込領域23と蓄積領域24との間に特別なゲート構造を設けることなく、埋込領域23の片側にのみ設けられた排出ゲート電極31の電位制御だけで、光による発生電子の蓄積領域24への蓄積量（又は蓄積状態）を変調することができる。又、排出ゲート電極31に制御信号TXDとして低い電圧を与えたときには、埋込領域23から蓄積領域24の方に向かう空乏化電位の傾きが形成されているので、埋込領域23から蓄積領域24にすべての電荷を転送する完全転送が実現できる。この完全転送により、残像を防止でき、残電荷によるランダムノイズの発生を防止できる。

#### 【0034】

この様に、第1の実施の形態に係る固体撮像装置によれば、埋込領域23の片側にのみ、電位勾配変更手段（31, 33）をなす排出ゲート電極31が設けられ、排出ゲート電極31の電位制御だけで、蓄積領域24への信号電荷の転送/非転送を制御することができるので、特許文献3で提案した構造の場合のような、電荷の通路の中心付近でポテンシャル傾斜が0になってしまう不都合もなく、電荷転送経路の全幅においてポテンシャル傾斜を生じさせることができるので、画素の構造が簡単化され、電荷の転送効率が高くなり、高解像度化及び高速動作が可能になる。又、埋込領域23から蓄積領域24に至る電荷転送経路にゲート構造やスイッチがないため、ゲート電極下を電子が通過するときのシリコン/酸化膜界面（Si-SiO<sub>2</sub>界面）での電子のトラップがなく、高速転送が可能となるため、時間分解能が向上する。更に、埋込領域23と蓄積領域24が1つの埋込フォトダイオード構造となっているため、暗電流ノイズ、転送ノイズ等のノイズの抑制の点からも有利となる。更に、蓄積領域24の下方に、ブロック層25を備えているので、排出ゲート電極31の電位制御による発生電子の蓄積領域24への転送の変調特性に対する、半導体領域21の深い位置で発生した電子が表面に拡散によって戻ってくる影響を抑制することができる。

#### 【0035】

一方、読み出しゲート電極32は、ゲート絶縁膜33を介して転送チャネルの電位を静電的に制御する。例えば、読み出しゲート電極32に制御信号TXとして低い電圧（0V、又は負電圧）を与えると、蓄積領域24と読み出し領域28との間に電子に対する電位障壁が形成され、蓄積領域24から読み出し領域28へ電荷は転送されない。一方、読み出しゲート電極32に制御信号TXとして高い電圧（正の電圧）を与えると、蓄積領域24と読み出し領域28との間の電位障壁の高さが減少、若しくは消滅し、蓄積領域24から読み出し領域28へ電荷が転送される。

#### 【0036】

図3（a）に示すように、読み出し領域28には、読み出し用バッファアンプを構成す

10

20

30

40

50

る信号読み出しトランジスタ（増幅トランジスタ） $T A_{ij}$ のゲート電極が接続されている。信号読み出しトランジスタ $T A_{ij}$ のドレイン電極は電源 $VDD$ に接続され、信号読み出しトランジスタ $T A_{ij}$ のソース電極は画素選択用のスイッチングトランジスタ $T S_{ij}$ のドレイン電極に接続されている。画素選択用のスイッチングトランジスタ $T S_{ij}$ のソース電極は、垂直信号線 $B_j$ に接続され、スイッチングトランジスタ $T S_{ij}$ のゲート電極には水平ラインの選択用制御信号 $S(i)$ が垂直走査回路3から与えられる。選択用制御信号 $S(i)$ をハイ(H)レベルにすることにより、スイッチングトランジスタ $T S_{ij}$ が導通し、信号読み出しトランジスタ $T A_{ij}$ で増幅された読み出し領域28の電位に対応する電流が垂直信号線 $B_j$ に流れる。更に、読み出し領域28には、読み出し用バッファアンプを構成するリセットトランジスタ $T R_{ij}$ のソース電極が接続されている。リセットトランジスタ $T R_{ij}$ のドレイン電極は電源 $VDD$ に接続され、リセットトランジスタ $T R_{ij}$ のゲート電極にはリセット信号 $R(i)$ が与えられる。リセット信号 $R(i)$ をハイ(H)レベルにして、リセットトランジスタ $T R_{ij}$ が読み出し領域28に蓄積された電荷を吐き出し、読み出し領域28をリセットする。

10

20

30

40

50

#### 【0037】

半導体領域21は、不純物密度 $5 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$ 程度以上、 $5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ 程度以下程度が好ましい。図3(b)及び図3(c)に示すように、蓄積領域24の多数キャリアに対するポテンシャル谷の底の電位が、埋込領域23がなすポテンシャル谷の底の電位よりも深くなるように、蓄積領域24の不純物密度は埋込領域23よりも高く設定している。例えば、埋込領域23の不純物密度は、 $1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 程度以上、 $8 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 程度以下、好ましくは $2 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 程度以上、 $1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 程度以下、代表的には、例えば $8 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 程度の比較的空乏化が容易な値が採用可能であり、その厚さは $0.1 \sim 3 \mu\text{m}$ 程度、好ましくは $0.1 \sim 0.3 \mu\text{m}$ 程度とすることが可能である。一方、蓄積領域24の不純物密度は、 $1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 程度以上、 $8 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 程度以下、好ましくは $4 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 程度以上、 $2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 程度以下、代表的には、例えば $1.6 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 程度の値が採用可能であり、その厚さは $0.1 \sim 3 \mu\text{m}$ 程度、好ましくは $0.1 \sim 0.3 \mu\text{m}$ 程度とすることが可能である。蓄積領域24の不純物密度は、埋込領域23の不純物密度の1.2~5倍、好ましくは1.5~2.5倍程度に設定しておけば、蓄積領域24のポテンシャル谷の底の電位が、埋込領域23がなすポテンシャル谷の底の電位よりも適度に深くなる。

#### 【0038】

ゲート絶縁膜33を熱酸化膜で形成する場合は、熱酸化膜の厚さは、150nm程度以上、1000nm程度以下、好ましくは200nm程度以上、400nm程度以下とすれば良い。ゲート絶縁膜33を熱酸化膜以外の誘電体膜とする場合は、熱酸化膜の比誘電率 $\epsilon_r$ (1MHzで $\epsilon_r = 3.8$ )で換算した等価な厚さとすれば良い。例えば、比誘電率 $\epsilon_r = 4.4$ であるCVD酸化膜を用いるのであれば上記厚さを $4.4 / 3.8 = 1.16$ 倍した厚さを、比誘電率 $\epsilon_r = 7$ であるシリコン窒化物( $\text{Si}_3\text{N}_4$ )膜をゲート絶縁膜33に用いるのであれば上記厚さを $7 / 3.8 = 1.84$ 倍した厚さを採用すれば良い。但し、標準的なCMOS技術で形成される酸化膜( $\text{SiO}_2$ 膜)をゲート絶縁膜33に用いるのが好ましく、CMOS技術におけるフィールド酸化膜をゲート絶縁膜33に用いるのが製造工程の簡略化に適している。

#### 【0039】

図3(a)に示すように、遮光膜41の開口部42は、光電荷の発生が、フォトダイオードD1を構成している埋込領域23の直下の半導体領域21で生じるように選択的に設けられている。図3(a)では、ゲート絶縁膜33のみを示しているが、遮光膜41は、図示を省略した多層配線構造をなす複数の層間絶縁膜の内のいずれかの上部に設けられたアルミニウム(Al)等の金属薄膜で構成すれば良い。

#### 【0040】

< 固体撮像装置の動作：距離画像センサ >

図2及び図3(a)に概略構成を示したロックインピクセルの応用を以下に説明する。

即ち、光源からパルス幅  $T_o$  の繰り返しパルス信号として照射された光が、対象物で反射され、レンズを介して、図 1 に示した固体撮像装置（2次元イメージセンサ）のそれぞれの画素  $X_{11} \sim X_{1m}; X_{21} \sim X_{2m}; \dots; X_{n1} \sim X_{nm}$  に入射する。即ち、図 3 (a) に示したように、それぞれの画素  $X_{11} \sim X_{1m}; X_{21} \sim X_{2m}; \dots; X_{n1} \sim X_{nm}$  の遮光膜 4 1 の開口部 4 2 を介して、それぞれの画素  $X_{11} \sim X_{1m}; X_{21} \sim X_{2m}; \dots; X_{n1} \sim X_{nm}$  のフォトダイオード D 1 に入射する。フォトダイオード D 1 は、遮光膜の開口部 4 2 を介して入射したパルス幅  $T_o$  のパルス光を光信号として受光し、この光信号を電荷に変換する。この際、図 5 に示すタイミング図のように、埋込領域 2 3 の片側にのみ設けられた排出ゲート電極 3 1 に制御信号 T X D として高い電圧（正の電圧）を受信したパルス幅  $T_o$  の光パルスのタイミングに対して与える。

10

## 【0041】

既に説明したとおり、排出ゲート電極 3 1 に制御信号 T X D として高い電圧（正の電圧）を与えると、図 3 (c) に示すような傾きのポテンシャル分布に起因する電界によって、埋込領域 2 3 で発生した殆どの電子は排出領域 2 7 に排出される。一方、排出ゲート電極 3 1 に制御信号 T X D として低い電圧（0 V、又は - 1 V 程度の負電圧）を与えると、図 3 (b) に示すようなポテンシャル分布によって、埋込領域 2 3 で発生した殆どの電子（電荷）が、蓄積領域 2 4 に転送される。

## 【0042】

先ず、図 5 (a) のように、パルス幅  $T_o$  の受信光パルスが排出ゲート電極 3 1 に印加する制御信号 T X D の立ち上がりエッジに、光パルスの遅れ時間  $T_d$  分、遅れてかかるようなタイミングで発光させた場合、光パルスによって埋込領域 2 3 で発生し、蓄積領域 2 4 に蓄積される電荷  $Q_1$  は、

20

$$Q_1 = I_p (T_o - T_d) + Q_B + Q_{SR} \quad \dots (1)$$

で与えられる。ここで、 $I_p$  は受信光パルスにより発生する光電流、 $Q_B$  は背景光による電荷、 $Q_{SR}$  は受信光パルスによって発生した電荷の内、応答速度が遅く、埋込領域 2 3 中でオフセット電荷としてふるまう成分である。

## 【0043】

図 5 (b) では、計測対象とする測距範囲において、パルス幅  $T_o$  の受信光パルスによる埋込領域 2 3 で発生した電荷は、すべて蓄積領域 2 4 に蓄積されるように光パルスのタイミングを設定しており、この場合に、蓄積される電荷  $Q_2$  は、

30

$$Q_2 = I_p T_o + Q_B + Q_{SR} \quad \dots (2)$$

と表される。

## 【0044】

図 5 (c) では、受信した光パルスにより埋込領域 2 3 で発生した成分は、すべて排出領域 2 7 に排出されるように光パルスのタイミングを設定している。この場合は、応答速度の遅いオフセット電荷の成分  $Q_{SR}$  と背景光による成分  $Q_B$  が蓄積領域 2 4 に蓄積されるように取り込まれ、

40

$$Q_3 = Q_B + Q_{SR} \quad \dots (3)$$

で表される。式 (3) から、式 (1)、式 (2) に含まれる背景光による成分  $Q_B$  と電荷の成分の内、応答速度の遅いオフセット電荷の成分  $Q_{SR}$  をキャンセルすることにより、光パルスの遅れ時間  $T_d$  を求めることができることが分かる。即ち、光パルスの遅れ時間  $T_d$  は、

$$T_d = T_o (Q_2 - Q_1) / (Q_2 - Q_3) \quad \dots (4)$$

50

から求めることができるので、対象物までの距離  $L$  は、光速  $c$  を用いて、

$$L = (c/2)T_d = (c/2)T_o(Q_2 - Q_1)/(Q_2 - Q_3) \dots (5)$$

により求められる。

【0045】

実際には、図5で示した排出ゲート電極31に印加する制御信号TXDの繰り返し周期  $T_g$  を1サイクルとして、多数回繰り返し、十分な電子数を蓄積領域24に蓄積したのち、各画素の信号をイメージセンサの外部に読み出す。その一連の操作を図5(a), (b), (c)に対して順次行い、読み出された各電荷量に比例した信号電圧或いは、その信号電圧に比例したデジタル値により、デジタル領域での演算で、式(5)に相当する処理を行うことで距離が求められる。

10

【0046】

実際のイメージセンサの読み出しのタイミングの例を、図6に示す。図1に示した固体撮像装置(2次元イメージセンサ)では、図2及び図3(a)の排出ゲート電極31に、全画素共通の制御信号TXDを与え、同じタイミングで動作させる。或いは、例えば、行毎にタイミングの異なる信号を加え、読み出し動作と連動させて与えても良い。図6のように、「光照射」の期間で、排出ゲート電極31に制御信号TXDを繰り返し周期  $T_g$  で、多数回繰り返し印加し、電荷の排出領域27への排出と、蓄積領域24への転送を繰り返し、十分な電子数を蓄積領域24に蓄積する。その後、「読み出し」の期間で、図1に示した画素アレイ部1の各行の排出ゲート電極31に、垂直走査回路3から制御信号TX(1), ..., TX(i), ..., TX(n-2), TX(n-1), TX(n)を、図6に示すように、順に印加し、蓄積領域24の信号電子を読み出す。信号をイメージセンサの外部に読み出す方法については、従来の埋込フォトダイオードを用いた電荷転送型のCMOSイメージセンサと違いはなく、詳細な説明は省略する。図6では、読み出し期間における、各行毎に与えるTX信号のタイミングだけを示している。

20

【0047】

第1の実施の形態に係る固体撮像装置によれば、変調された光信号と同期して電荷の検出を行う場合において、信号検出のための電荷転送経路が一種類であるため、例えばフォトダイオードからの複数の蓄積領域24にゲート電極構造を介して、電荷を振り分ける従来の構造と比較して、画素毎に特性ばらつきを少なくした距離画像センサを実現することができる。又、第1の実施の形態に係る固体撮像装置によれば、埋込領域23の片側のみ、電位勾配変更手段(31, 33)をなす排出ゲート電極31が設けられ、排出ゲート電極31の電位制御だけで、蓄積領域24への信号電荷の転送/非転送を制御することができるので、特許文献3で提案した構造の場合のような、電荷の通路の中心付近でポテンシャル傾斜が0になってしまう不都合もない。

30

【0048】

<固体撮像装置の動作：蛍光強度及び蛍光の寿命測定>

次に、本発明の第1の実施の形態に係る固体撮像装置の応用例として、対象物の蛍光の寿命を画像化する方法を説明する。蛍光寿命の測定は、バイオイメージングにおいて有用であり、その計測が半導体デバイスと簡単な光源及び光学系で実現することができれば、蛍光の寿命測定の応用範囲を拡大することができる。

40

【0049】

図7は、排出ゲート電極31に制御信号TXDとして低い電圧(0V、又は-1V程度の負電圧)を印加する期間  $T_g$  を短くし、そのパルスのタイミング  $T_d$  を1フレーム毎に変化させることで蛍光の寿命を測定する場合のタイミング図を示している。期間  $T$  の間以外は、排出ゲート電極31に制御信号TXDとして高い電圧を与えて、埋込領域23の電荷を排出領域27へ排出する。繰り返しパルスの励起光を照射したとき、励起光が照射された対象物からの蛍光は遅れて応答する。

50

## 【 0 0 5 0 】

蛍光は指数関数的に減衰するため、蛍光の強度を  $P$  とすると、蛍光  $P$  と時間  $T$  との関係は、 $\tau$  を蛍光の寿命、 $P_0$  を蛍光の強度の初期値として、式 ( 6 ) のように表すことができる：

$$P = P_0 \exp(-t / \tau) \quad \dots ( 6 )$$

## 【 0 0 5 1 】

図 7 において、タイミング  $T_d = t_1$  から期間  $T$  の間、制御信号  $T \times D$  として低い電圧を排出ゲート電極 3 1 に与えて、蛍光による電荷を蓄積領域 2 4 に転送したとき、蛍光電荷の転送の遅れ時間を無視すれば、転送電荷  $Q_1$  は、式 ( 7 ) のように、時刻  $t_1$  から  $t_1 + T$  の期間の積分で与えられる：

$$Q_1 = k \int_{t_1}^{t_1 + \Delta T} P_0 \exp(-t / \tau) dt = k P_0 \tau \exp(-t_1 / \tau) (1 - \exp(-\Delta T / \tau))$$

... ( 7 )

この転送動作を何度も繰り返す。このとき、蛍光の寿命が変化せず、同じ蛍光を繰り返すとすれば、 $N$  回の繰り返しにより、その電荷は  $N$  倍になる。

## 【 0 0 5 2 】

同様に、図 1 1 において、時刻  $t_1$  とは異なるタイミング  $T_d = t_2$  から期間  $T$  の間、制御信号  $T \times D$  として低い電圧を排出ゲート電極 3 1 に与えて、蛍光による電荷を蓄積領域 2 4 に転送したとき、蛍光電荷の転送の遅れ時間を無視すれば、転送電荷  $Q_2$  は、式 ( 8 ) のように、時刻  $t_2$  から  $t_2 + T$  の期間の積分で与えられる：

$$Q_2 = k \int_{t_2}^{t_2 + \Delta T} P_0 \exp(-t / \tau) dt = k P_0 \tau \exp(-t_2 / \tau) (1 - \exp(-\Delta T / \tau))$$

... ( 8 )

式 ( 7 ) 及び式 ( 8 ) から、蛍光の寿命  $\tau$  は以下の式 ( 9 ) のように表すことができる：

$$\tau = (t_2 - t_1) / \ln(Q_1 / Q_2) \quad \dots ( 9 )$$

## 【 0 0 5 3 】

したがって、蛍光により発生した電荷を異なるタイミングで読み出すことにより、蛍光の寿命  $\tau$  を測定可能となる。尚、イメージセンサとしての全体的な読み出しの動作は、図 6 を用いて説明した動作と実質的に同様であるので、重複した説明を省略する。

## 【 0 0 5 4 】

第 1 の実施の形態に係る固体撮像装置によれば、特許文献 3 で提案した構造の場合のような、電荷の通路の中心付近でポテンシャル傾斜が 0 になってしまう不都合もなく、電荷転送経路の全幅においてポテンシャル傾斜を生じさせることができ、変調された光信号と同期して電荷の検出を行う場合において、信号検出のための電荷転送経路が一種類であるため、例えばフォトダイオードからの複数の蓄積領域 2 4 にゲート電極構造を介して、電荷を振り分ける従来の構造に比較して画素毎に特性ばらつきを少なくして、蛍光の寿命を

10

20

30

40

50

画像化することができる。

【 0 0 5 5 】

図 7 に示したタイミング図は、蛍光寿命を測る場合だけでなく、蛍光の強度を測るものにも使える。蛍光の強度の測定は、単に時間的に窓をかけて、励起光の成分を捨てて（排出）、蛍光が発生しているときだけ、転送するようにすれば良い。その時間窓のタイミングは固定であるが、蛍光をできるだけ集めたいので、励起光のすぐ後で、開きはじめ、十分に減衰するまで時間窓を広く、即ち  $T$  を大きくする。

【 0 0 5 6 】

よって、蛍光強度イメージングの場合は、時間窓  $T$  を固定として、励起光による電荷を十分に排出したのちに、排出ゲートを閉じ、蛍光により発生した電荷のみを電荷蓄積部に転送する。従来、蛍光強度イメージングでは、励起光による成分と蛍光による成分の分離は、それらの波長が異なることを利用し、光の波長に対して選択する光学フィルタのみが用いられているが、励起光と蛍光の波長成分が一部重なりあうため、励起光が必ずしも十分に分離できない場合がある。本発明のように、時間窓による選択を併用することで、より分離性が高まり、より微弱な蛍光を検出することができる。

10

【 0 0 5 7 】

（第 2 の実施の形態）

第 1 の実施の形態に係る固体撮像装置の画素では、読み出しゲート電極 3 2 の電位制御によって、蓄積領域 2 4 に蓄積された電荷を読み出し領域 2 8 に転送したが、図 8 に平面図を示すように、固体撮像装置の画素  $X_{ij}$  の一部としての半導体素子を、読み出し領域 2 8 a が埋込領域 2 3 a の内部で、且つ蓄積領域 2 4 a の内部に位置するようにし、読み出しゲート電極を設けずに蓄積領域 2 4 a に蓄積された電荷を直接読み出し領域 2 8 に転送するようにしても良い。

20

【 0 0 5 8 】

図 9 ( a ) に、図 8 の B - B 方向から見た階段断面図を示すように、本発明の第 2 の実施の形態に係る固体撮像装置の画素（半導体素子）は、第 1 導電型（ p 型）の半導体領域 2 1 と、半導体領域 2 1 の上部の一部に埋込まれ、半導体領域 2 1 とフォトダイオードをなす第 2 導電型（ n 型）の埋込領域（受光カソード領域） 2 3 a と、埋込領域 2 3 a から離間して半導体領域 2 1 の一部に設けられ、特定のタイミングにおいて埋込領域 2 3 a からフォトダイオードが生成した電荷を排出する、埋込領域 2 3 a よりも高不純物密度で第 2 導電型（ n + 型）の排出領域 2 7 と、半導体領域 2 1 の一部に設けられ、電荷の非排出時に電荷を埋込領域 2 3 a から転送され、読み出されるまで蓄積する、埋込領域 2 3 a よりも高不純物密度で第 2 導電型（ n + 型）の読み出し領域 2 8 a と、埋込領域 2 3 a と排出領域 2 7 との間の半導体領域 2 1 からなるチャンネルの上部に設けられ、チャンネルの電位を制御して、埋込領域 2 3 a から読み出し領域 2 8 a へ至るポテンシャルプロファイルの少なくとも一部の電位勾配、及び埋込領域 2 3 a から排出領域 2 7 へ至るポテンシャルプロファイルの電位勾配を変化させ、電荷の転送の少なくとも一部及び電荷の排出を制御する電位勾配変更手段（ 3 1 , 3 2 ）とを備える。本発明の第 2 の実施の形態に係る固体撮像装置の画素（半導体素子）は、読み出し領域 2 8 a を囲んで読み出し領域 2 8 a に連続して設けられ、埋込領域 2 3 a の多数キャリアに対する埋込領域 2 3 a がなすポテンシャル谷の底の電位よりも深く、読み出し領域 2 8 a がなす多数キャリアに対するポテンシャル井戸の深さよりも浅いポテンシャル谷を形成する第 2 導電型（ n 型）の蓄積領域 2 4 a を更に備える（図 9 ( b ) 及び図 9 ( c ) 参照。）。電位勾配変更手段（ 3 1 , 3 2 ）は、電荷の転送時において、埋込領域 2 3 a から蓄積領域 2 4 a へ向かい次第に電位が下がる電位勾配を形成し、電荷を埋込領域 2 3 a から蓄積領域 2 4 a へ転送する。図 8 の平面図では、読み出し領域 2 8 a が埋込領域 2 3 a の内部に設けられているが、読み出し領域 2 8 a は埋込領域 2 3 a の内部に完全に含まれている必要はなく、読み出し領域 2 8 a は埋込領域 2 3 a と連続、又は埋込領域 2 3 a と少なくとも一部を重複して設けられていても良い。

30

40

【 0 0 5 9 】

50



図9(a)に示すように、埋込領域23aに光が選択的に入射するように、遮光膜41の開口部42が設けられている。遮光膜41の開口部42を設けることにより、光電荷の発生が、フォトダイオードD1を構成している埋込領域23aの直下の半導体領域21で生じる。図9(a)では、ゲート絶縁膜33のみを示しているが、遮光膜41は、図示を省略した多層配線構造をなす複数の層間絶縁膜の内のいずれかの上部に設けられたアルミニウム(A1)等の金属薄膜で構成すれば良いのも第1の実施の形態に係る固体撮像装置と同様である。

#### 【0060】

本発明の第2の実施の形態に係る固体撮像装置の画素(半導体素子)は、第1の実施の形態に係る固体撮像装置と同様に、蓄積領域24aの下方に設けられ、半導体領域21より高不純物密度の第1導電型(p<sup>+</sup>型)のブロック層25aと、埋込領域23aの上から蓄積領域24aの上に渡り設けられた、第1導電型(p<sup>+</sup>型)のピニング層26aとを更に備える。そして、図8に破線で示したように、ピニング層26a、ピニング層26aの下方の埋込領域23a、排出領域27、蓄積領域24aを囲むように、半導体領域21より高不純物密度の第1導電型のウェル領域(pウェル)22が形成されている。破線の更に外側のピニング層26aを囲む太い実線30aは、素子分離領域との境界を示す。即ち、図8に示す太い実線30aの外側が、LOCOS法やSTI法等によって形成される素子分離絶縁膜の領域である。

#### 【0061】

第2の実施の形態に係る固体撮像装置の画素(半導体素子)には読み出しゲート電極はないが、ゲート絶縁膜33上には、埋込領域23aと排出領域27との間に形成される排出チャンネルの電位を制御して、埋込領域23aから、埋込領域23aが生成した電子を排出領域27へ転送する排出ゲート電極31が埋込領域23aの片側にのみ、配置されている。ゲート絶縁膜33とゲート絶縁膜33上の排出ゲート電極31とで、埋込領域23aと排出領域27との間の半導体領域21の上部に形成されるチャンネルの電位を制御し、ポテンシャルプロファイル(電位勾配)を変更して、埋込領域23aから排出領域27への電荷を排出/非排出、及び埋込領域23aから蓄積領域24aへの信号電荷の転送/非転送を制御する電位勾配変更手段(31, 33)を構成している。

#### 【0062】

図9(b)及び図9(c)は、図9(a)の階段断面図において、埋込領域23a、蓄積領域24a、読み出し領域28aを水平面で切った断面におけるポテンシャル図であり、電荷(電子)を黒丸で示している。図9(a)に対応して、図9(b)及び図9(c)の左側に、排出領域27のポテンシャル井戸のフェルミレベル以下の電子が充満した状態を右上がりのハッチングで示す。又、排出領域27のポテンシャル井戸の右側に、埋込領域23aの伝導帯端の位置を示すポテンシャル谷(第1のポテンシャル谷)PW1と、第1のポテンシャル谷PW1の右側に、蓄積領域24aの伝導帯端の位置を示すポテンシャル谷(第2のポテンシャル谷)PW2を示す。第2のポテンシャル谷PW2の中央部に、第2のポテンシャル谷PW2の底よりも深い読み出し領域28aのポテンシャル井戸を示す。読み出し領域28aのポテンシャル井戸の深さは、フェルミレベルになるので、図9(b)及び図9(c)においては、右上がりのハッチングで示した領域の上端のレベルが、ポテンシャル井戸の深さを定義する。読み出し領域28aを示す深いポテンシャル井戸の周りのフェルミレベルの上方の位置には、読み出し領域28aよりも浅い第2のポテンシャル谷PW2の底を示す伝導帯端が囲み、第2のポテンシャル谷PW2が読み出し領域28aがなす深いポテンシャル井戸に単調に連続している。蓄積領域24aの多数キャリアに対するポテンシャル谷の底の電位が、埋込領域23aがなすポテンシャル谷の底の電位よりも深く、読み出し領域28aがなすポテンシャル井戸の深さよりも浅くなるように、蓄積領域24aの不純物密度は埋込領域23aよりも高く、読み出し領域28aの不純物密度よりも低く設定している。

#### 【0063】

第1のポテンシャル谷PW1とその左側に示した排出領域27の深いポテンシャル井戸

との間の電位障壁は、排出ゲート電極 3 1 の直下の半導体領域 2 1 の伝導帯端のポテンシャル分布に相当する。例えば、排出ゲート電極 3 1 に、制御信号 TXD として、低い電位 (0 V、又は -1 V 程度の負電圧) を与えると、図 9 (b) に示すように、埋込領域 2 3 と排出領域 2 7 との間に電子に対する電位障壁が形成され、埋込領域 2 3 から蓄積領域 2 4 a の方に向かう空乏化電位の傾きが発生する。図 9 (b) に示すようなポテンシャル分布に起因する電界によって、埋込領域 2 3 a で発生した殆どの電子 (電荷) が、蓄積領域 2 4 a に転送され、更に蓄積領域 2 4 a を示す第 2 のポテンシャル谷 PW 2 を経由して、読み出し領域 2 8 a の深いポテンシャル井戸へ転送される。

#### 【0064】

一方、排出領域 2 7 に接続された排出ゲート電極 3 1 に制御信号 TXD として高い電位 (正の電圧) を与えると、図 9 (c) に示すように、埋込領域 2 3 a から左側の排出領域 2 7 の深いポテンシャル井戸に向かう空乏化電位の傾きが発生する。図 9 (c) に示すようなポテンシャル分布に起因する電界によって、埋込領域 2 3 a で発生した電子は、排出領域 2 7 に排出され、読み出し領域 2 8 a の深いポテンシャル井戸へは転送できなくなる。

#### 【0065】

図 8 及び図 9 (a) に示すように、電荷が埋込領域 2 3 a から排出されるとき、電荷流入面の主面となる排出領域 2 7 の端部が、排出ゲート電極 3 1 直下において、平面パターン上で、埋込領域 2 3 a の端部と平行に対峙している。そして、排出ゲート電極 3 1 が埋込領域 2 3 a の一部に重複し且つ隣接するように配置されているので、電位勾配変更手段 (3 1, 3 3) によって、ポテンシャルプロファイル (電位勾配) を変更する際には、埋込領域 2 3 a の排出領域 2 7 に対向する部分の全体において、排出領域 2 7 に向かう電界を排出ゲート電極 3 1 直下の半導体領域 2 1 に発生させることができる。よって、第 2 の実施の形態に係る半導体素子は、電荷の排出領域 2 7 への排出効率を向上させ、且つ埋込領域 2 3 a から蓄積領域 2 4 a を経て読み出し領域 2 8 a へ至る信号電荷の高速転送を実現することが可能であると共に、画素の構造を簡単化できる。更に、第 2 の実施の形態に係る半導体素子は、読み出し領域 2 8 a に電荷を転送するための読み出しゲート電極を省略しているため、半導体素子の構造が簡単化され、画素の面積を小さくでき、高空間解像度で高速動作するイメージセンサを実現できる。但し、通常の読み出しでは、リセットノイズがキャンセルされないことと、半導体表面で電荷を蓄積することから、暗電流が大きくなる点に注意が必要である。

#### 【0066】

この様に、第 2 の実施の形態に係る固体撮像装置によれば、埋込領域 2 3 a の片側のみ、排出ゲート電極 3 1 が設けられ、排出ゲート電極 3 1 の電位制御だけで、蓄積領域 2 4 a への信号電荷の転送 / 非転送を制御することができるので、特許文献 3 で提案した構造の場合のような、電荷の通路の中心付近でポテンシャル傾斜が 0 になってしまう不都合もなく、電荷転送経路の全幅においてポテンシャル傾斜を生じさせることができるので、画素の構造が簡単化され、電荷の転送効率が高くなり、高解像度化及び高速動作が可能になる。

#### 【0067】

(第 3 の実施の形態)

又、既に述べた第 2 の実施の形態の説明では、図 8 及び図 9 に示したように、読み出し領域 2 8 a を蓄積領域 2 4 a の表面の中央付近に位置するようにし、蓄積領域 2 4 a の下方に、半導体領域 2 1 より高不純物密度の第 1 導電型 (p<sup>+</sup> 型) のブロック層 2 5 a を設け、読み出しゲート電極を設けずに蓄積領域 2 4 に蓄積された電荷を直接読み出し領域 2 8 に転送する構造を示したが、本発明の第 3 の実施の形態に係る固体撮像装置の画素 X<sub>ij</sub> の一部としての半導体素子では、図 1 1 に示すように、第 2 の実施の形態で用いた蓄積領域 2 4 a 及びブロック層 2 5 a の領域をなくして、ウェル領域 (p ウェル) 2 2 b を読み出し領域 2 8 b と重ねるレイアウトを採用している。図 1 1 の平面図において、破線で示した領域の外側がウェル領域 2 2 b である。図 1 1 は平面図なので、ゲート絶縁膜の図示

を省略しているが、ゲート絶縁膜とゲート絶縁膜上の排出ゲート電極 3 1 とで、埋込領域 2 3 b と排出領域 2 7 との間の半導体領域 2 1 の上部に形成されるチャンネルの電位を制御し、ポテンシャルプロファイル（電位勾配）を変更して、埋込領域 2 3 b から排出領域 2 7 への電荷を排出 / 非排出、及び埋込領域 2 3 b から読み出し領域 2 8 b への信号電荷の転送 / 非転送を制御する電位勾配変更手段を構成している。

【 0 0 6 8 】

図 1 1 に示すように、電荷が埋込領域 2 3 b から排出されるとき、電荷流入面の主面となる排出領域 2 7 の端部が、排出ゲート電極 3 1 直下において、平面パターン上で、埋込領域 2 3 b の端部と平行に対峙している。そして、埋込領域 2 3 b の片側のみにおいて、排出ゲート電極 3 1 が埋込領域 2 3 b の一部に重複し且つ隣接するように配置されているので、電位勾配変更手段によって、ポテンシャルプロファイル（電位勾配）を変更する際には、埋込領域 2 3 b の排出領域 2 7 に対向する部分の全体において、排出領域 2 7 に向かう電界を排出ゲート電極 3 1 直下の半導体領域 2 1 に発生させることができる。よって、第 3 の実施の形態に係る半導体素子は、電荷の排出領域 2 7 への排出効率を向上させ、且つ埋込領域 2 3 b から読み出し領域 2 8 b への信号電荷の高速転送を実現することが可能であると共に、画素の構造を簡単化できる。特に、第 3 の実施の形態に係る固体撮像装置の画素（半導体素子）には蓄積領域 2 4 a がないので、図 9 に示した第 2 のポテンシャル谷 P W 2 が無いポテンシャルプロファイルになる。このため、埋込領域 2 3 b がなすポテンシャル谷から読み出し領域 2 8 b がなすポテンシャル井戸への電位勾配に沿って、直接、電荷が高效率で転送され、ほぼ第 2 の実施の形態と同様な効果を奏する。

【 0 0 6 9 】

図 1 1 に示す第 3 の実施の形態に係る固体撮像装置の画素のレイアウトでは、ウェル領域 2 2 b の平面パターンと読み出し領域 2 8 b の平面パターンの一部が重複しているので、ウェル領域 2 2 b にブロック層 2 5 a と等価な機能を持たせることが可能で、半導体領域 2 1 からの読み出し領域 2 8 b への光の漏れ込みをなくすることができる。但し、図 1 1 に示すように、ウェル領域 2 2 b から読み出し領域 2 8 b の一部が突出して、ウェル領域 2 2 b の平面パターンと読み出し領域 2 8 b の平面パターンとが重複するレイアウトであるので、ウェル領域 2 2 b によって、埋込領域 2 3 b がなすポテンシャル谷から読み出し領域 2 8 b がなすポテンシャル井戸への経路にポテンシャルバリアが形成される可能性がある。第 3 の実施の形態に係る固体撮像装置の画素においてポテンシャルバリアが形成されないようにするためには、ウェル領域 2 2 b と読み出し領域 2 8 b の不純物密度の関係や相対的な位置関係を正確に決める必要がある。ウェル領域 2 2 b を示す破線の更に外側のピニング層 2 6 b を囲む太い実線 3 0 b は、素子分離領域との境界を示す。即ち、図 1 1 に示す太い実線 3 0 b の外側が、L O C O S 法や S T I 法等によって形成される素子分離絶縁膜の領域である。

【 0 0 7 0 】

この様に、第 3 の実施の形態に係る固体撮像装置によれば、埋込領域 2 3 b の片側のみ、排出ゲート電極 3 1 が設けられ、排出ゲート電極 3 1 の電位制御だけで、読み出し領域 2 8 b への信号電荷の転送 / 非転送を制御することができるので、特許文献 3 で提案した構造の場合のような、電荷の通路の中心付近でポテンシャル傾斜が 0 になってしまう不都合もなく、電荷転送経路の全幅においてポテンシャル傾斜を生じさせることができるので、画素の構造が簡単化され、電荷の転送効率が高くなり、高解像度化及び高速動作が可能になる。

【 0 0 7 1 】

（その他の実施の形態）

上記のように、本発明は第 1 ~ 第 3 の実施の形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面は本発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。

【 0 0 7 2 】

例えば、本発明の第 1 ~ 第 3 の実施の形態のいずれかで説明した構造を利用して、距離

測定等に用いる光源としてのLED照明を、背景光に対して相対的に増強させることもできる。この場合、図10に示すように、LEDが発光しているタイミングに合わせて、排出ゲート電極31に制御信号TXDとして低い電圧を与え、LEDにより生成された電荷を蓄積領域24に転送されるようにし、それ以外の期間では発生した電子が排出領域27に排出されるようにする。この場合、LEDを繰り返し発光させたときの、発光のデューティ比を小さくして、直流発光の場合に比べて、最大許容駆動電流を大きくすることができるので、同じ発光強度を得るのに必要なLEDの数を減らすことができる。

【0073】

本発明の第3の実施の形態に係る固体撮像装置では、図11に示すように、第2の実施の形態で用いた蓄積領域24a及びブロック層25aの領域をなくして、ウェル領域(pウェル)22bを読み出し領域28bと重ねるレイアウトを採用したが、蓄積領域24aの平面パターンを残すレイアウトを採用しても良い。即ち、図9に示した第2の実施の形態に係る固体撮像装置の画素のブロック層25aのパターンをなくすが、蓄積領域24aのパターンは利用し、読み出し領域の平面パターンの一部にウェル領域22aの平面パターンが重なるレイアウトを採用しても良い。この場合は、蓄積領域24aを残しているため、図9に示したと同様に第2のポテンシャル谷PW2が残り、埋込領域23bがなす第1のポテンシャル谷PW1から、第2のポテンシャル谷PW2を経由して、読み出し領域がなすポテンシャル井戸へ電荷が順に転送され、ほぼ第2の実施の形態と同様な効果を奏する。しかしながら、蓄積領域24aのパターンを残すレイアウトの場合には、蓄積領域24aの領域の下に比較的高濃度のp層がないため、半導体領域21から読み出し領域への電光の漏れ込み特性が不利になる。しかし、ブロック層25aをなくすレイアウトの採用によって、固体撮像装置の製造工程が簡単になるという利点がある。

【0074】

更に、既に述べた第1～第3の実施の形態に係る固体撮像装置の説明では、第1導電型をp型、第2導電型をn型として説明したが、第1導電型をn型、第2導電型をp型としても、電気的な極性を反対にすれば同様な効果が得られることは容易に理解できるであろう。

【0075】

又、既に述べた第1～第3の実施の形態の説明においては、2次元固体撮像装置(エリアセンサ)を例示的に説明したが、本発明の半導体素子は2次元固体撮像装置の画素のみに用いられるように限定して解釈するべきではない。例えば、図1に示した2次元マトリクスにおいて、 $j = m = 1$ とした1次元固体撮像装置(ラインセンサ)の画素として複数の半導体素子を1次元に配列しても良いことは、上記開示の内容から、容易に理解できるはずである。

【0076】

この様に、本発明はここでは記載していない様々な実施の形態等を含むことは勿論である。したがって、本発明の技術的範囲は上記の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発明特定事項によってのみ定められるものである。

【符号の説明】

【0077】

$X_{11} \sim X_{1m}; X_{21} \sim X_{2m}; \dots; X_{n1} \sim X_{nm}$ …画素

1…画素アレイ部

2…水平走査回路

3…垂直走査回路

4…タイミング発生回路

5…信号処理回路

21…半導体領域

22, 22a, 22b…ウェル領域(破線の外側がウェル領域)

23, 23a, 23b…埋込領域

24, 24a…蓄積領域

10

20

30

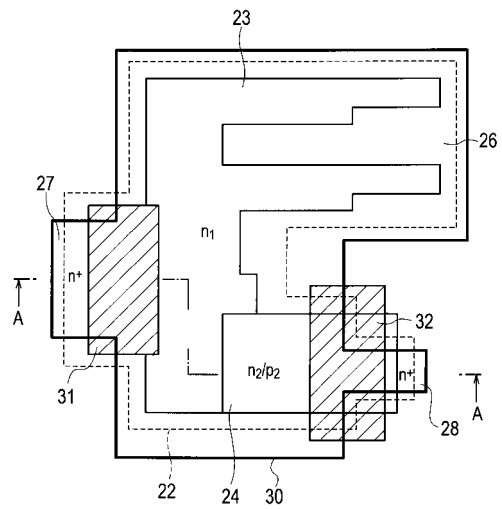
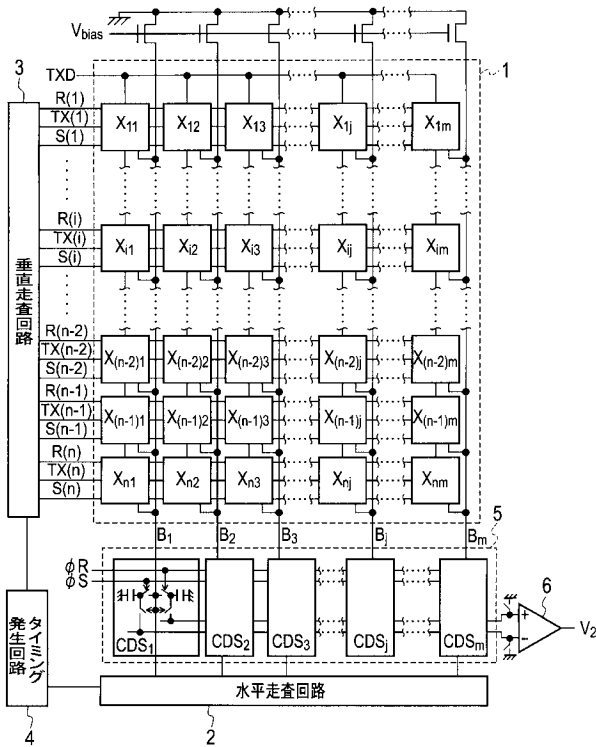
40

50

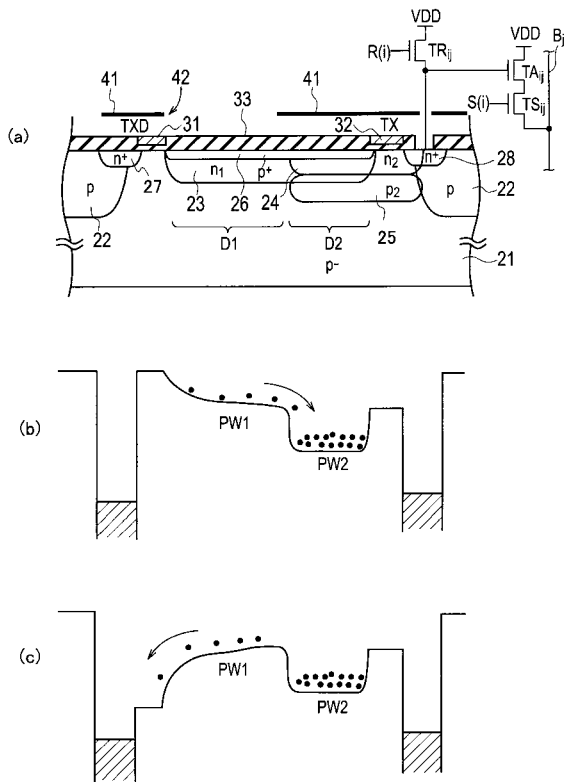
- 2 5 , 2 5 a ... ブロック層
- 2 6 , 2 6 a ... ピニング層
- 2 7 ... 排出領域
- 2 8 , 2 8 a , 2 8 b ... 電荷読みだし領域
- 3 0 ... 素子分離領域との境界を示す線 (太い実線の外側が素子分離絶縁膜)
- 3 1 ... 排出ゲート電極
- 3 2 ... 読み出しゲート電極
- 3 3 ... ゲート絶縁膜
- 4 1 ... 遮光膜
- 4 2 ... 開口部

【 図 1 】

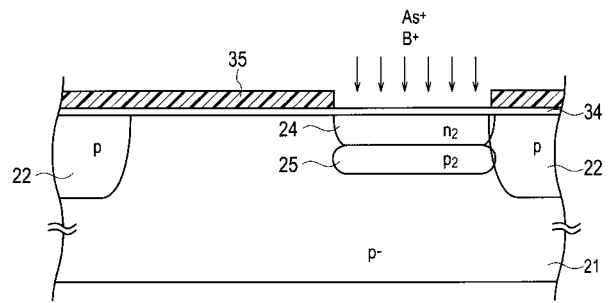
【 図 2 】



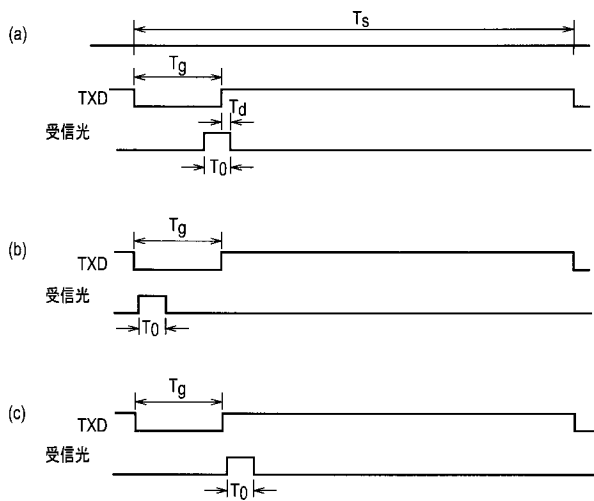
【 図 3 】



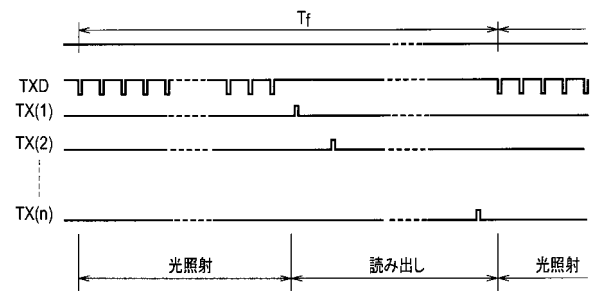
【 図 4 】



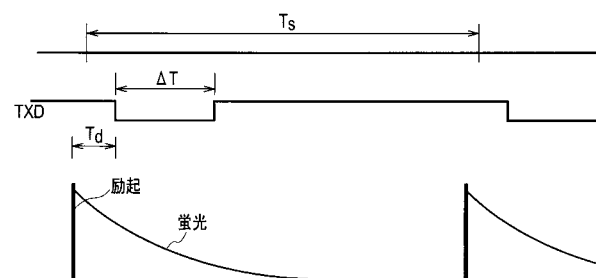
【 図 5 】



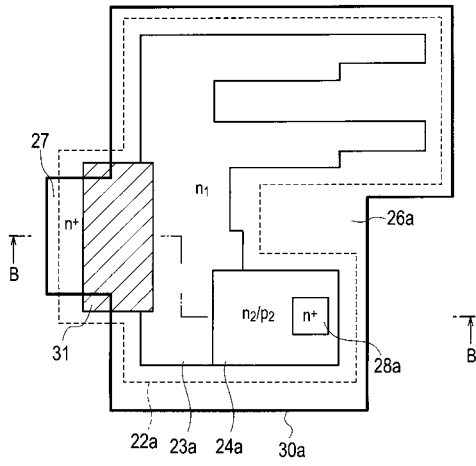
【 図 6 】



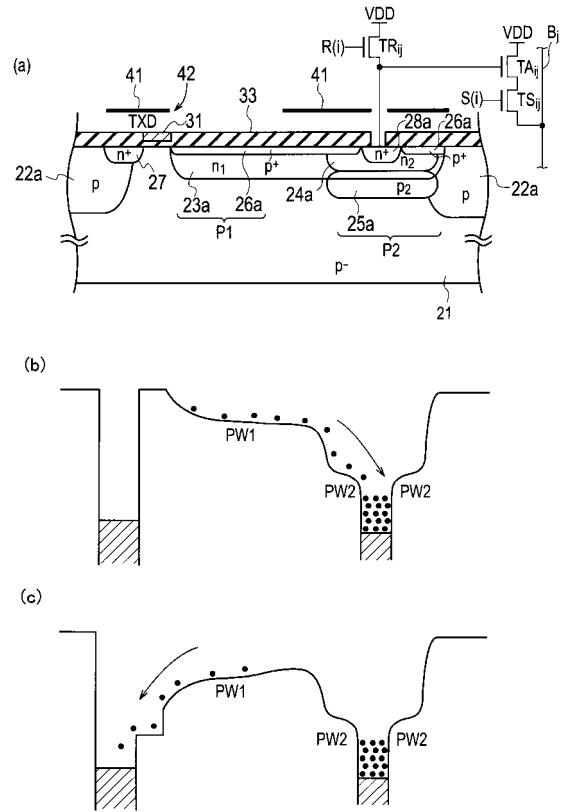
【 図 7 】



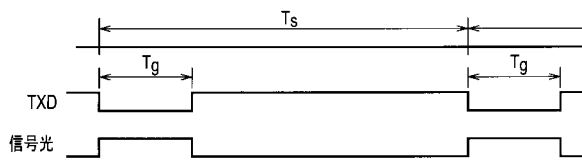
【 図 8 】



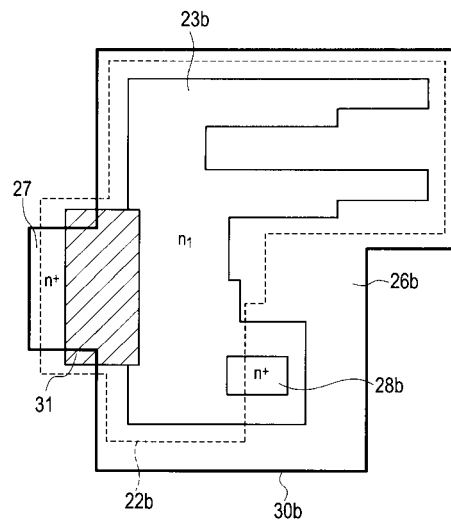
【 図 9 】



【 図 10 】



【 図 11 】



## 【手続補正書】

【提出日】平成23年8月4日(2011.8.4)

## 【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1導電型の半導体領域と、

前記半導体領域の上部の一部に埋め込まれ、前記半導体領域とフォトダイオードをなすように光信号が選択的に照射される第2導電型の埋込領域と、

前記埋込領域から離間して前記半導体領域の一部に設けられ、特定のタイミングにおいて前記埋込領域から前記フォトダイオードが生成した電荷を信号電荷に寄与しない電荷として排出する、前記埋込領域よりも高不純物密度で第2導電型の排出領域と、

前記半導体領域の一部に設けられ、前記電荷の非排出時に前記電荷を信号電荷として前記埋込領域から転送され、読み出されるまで前記信号電荷を蓄積する、前記埋込領域よりも高不純物密度で第2導電型の読み出し領域と、

前記埋込領域と前記排出領域との間の前記半導体からなるチャンネルの上部に設けられ、前記特定のタイミングにおいて前記チャンネルの電位を制御して、前記電荷が前記埋込領域から前記排出領域に排出され、且つ前記電荷の前記読み出し領域側への移動を阻止するような電位勾配に変化させる電位勾配変更手段

とを備え、前記埋込領域から前記読み出し領域へ至る経路が前記光信号に対し遮光され、前記特定のタイミングの終了後に前記電位勾配が、前記埋込領域から前記読み出し領域方向に前記信号電荷を転送するように戻ることの特徴とする半導体素子。

【請求項2】

前記読み出し領域が、前記埋込領域から離間して前記半導体領域の一部に設けられ、

前記埋込領域から前記読み出し領域に至る経路の一部の前記埋込領域側に設けられ、前記埋込領域の多数キャリアに対する前記埋込領域がなすポテンシャル谷の底の電位よりも深く、前記読み出し領域がなす前記多数キャリアに対するポテンシャル井戸の深さよりも浅いポテンシャル谷を形成する第2導電型の蓄積領域を更に備え、

前記信号電荷の転送時において、前記埋込領域から前記蓄積領域へ向かい次第に電位が下がる電位勾配を形成し、前記信号電荷を前記埋込領域から前記蓄積領域へ転送することの特徴とする請求項1に記載の半導体素子。

【請求項3】

前記読み出し領域が、前記埋込領域の内部、前記埋込領域と連続、又は前記埋込領域と少なくとも一部を重複して設けられ、

前記読み出し領域を囲んで前記読み出し領域に連続して設けられ、前記埋込領域の多数キャリアに対する前記埋込領域がなすポテンシャル谷の底の電位よりも深く、前記読み出し領域がなす前記多数キャリアに対するポテンシャル井戸の深さよりも浅いポテンシャル谷を形成する第2導電型の蓄積領域を更に備え、

前記信号電荷の転送時において、前記埋込領域から前記蓄積領域へ向かい次第に電位が下がる電位勾配を形成し、前記信号電荷を前記埋込領域から前記蓄積領域へ転送することの特徴とする請求項1に記載の半導体素子。

【請求項4】

前記蓄積領域が前記埋込領域よりも高不純物密度であることを特徴とする請求項2又は3に記載の半導体素子。

【請求項5】

前記読み出し領域が、前記埋込領域の内部、前記埋込領域と連続、又は前記埋込領域と少なくとも一部を重複して設けられ、



前記信号電荷の転送時に、前記埋込領域から前記読み出し領域へ向かい次第に電位が下がる電位勾配に沿って、前記信号電荷が前記埋込領域から前記読み出し領域へ直接転送されることを特徴とする請求項1に記載の半導体素子。

【請求項6】

前記電荷が前記埋込領域から排出されるとき、電荷流入面の主面となる排出領域の端部が、平面パターン上前記埋込領域の端部と平行に対峙していることを特徴とする請求項1～5のいずれか1項に記載の半導体素子。

【請求項7】

前記蓄積領域の下方に、第1導電型で前記半導体領域よりも高不純物密度のブロック層を更に備えることを特徴とする請求項2～5のいずれか1項に記載の半導体素子。

【請求項8】

前記排出領域の一部と前記読み出し領域の周囲を少なくとも囲む第1導電型のウェル領域を更に備え、

前記読み出し領域の少なくとも一部が、平面パターン上、前記ウェル領域の内部に含まれることを特徴とする請求項5に記載の半導体素子。

【請求項9】

第1導電型の半導体領域と、

前記半導体領域の上部の一部に埋め込まれ、前記半導体領域とフォトダイオードをなすように光信号が選択的に照射される第2導電型の埋込領域と、

前記埋込領域から離間して前記半導体領域の一部に設けられ、特定のタイミングにおいて前記埋込領域から前記フォトダイオードが生成した電荷を信号電荷に寄与しない電荷として排出する、前記埋込領域よりも高不純物密度で第2導電型の排出領域と、

前記半導体領域の一部に設けられ、前記電荷の非排出時に前記電荷を信号電荷として前記埋込領域から転送され、読み出されるまで前記信号電荷を蓄積する、前記埋込領域よりも高不純物密度で第2導電型の読み出し領域と、

前記埋込領域と前記排出領域との間の前記半導体領域からなるチャンネルの上部に設けられ、前記特定のタイミングにおいて前記チャンネルの電位を制御して、前記電荷が前記埋込領域から前記排出領域に排出され、且つ前記電荷の前記読み出し領域側への移動を阻止するような電位勾配に変化させる電位勾配変更手段

とを備える画素を複数配列し、それぞれの画素において、前記埋込領域から前記読み出し領域へ至る経路が前記光信号に対し遮光され、前記特定のタイミングの終了後に前記電位勾配が、前記埋込領域から前記読み出し領域方向に前記信号電荷を転送するように戻ること特徴とする固体撮像装置。

【請求項10】

前記読み出し領域が、前記埋込領域から離間して前記半導体領域の一部に設けられ、

前記埋込領域から前記読み出し領域に至る経路の一部の前記埋込領域側に設けられ、前記埋込領域の多数キャリアに対する前記埋込領域がなすポテンシャル谷の底の電位よりも深く、前記読み出し領域がなす前記多数キャリアに対するポテンシャル井戸の深さよりも浅いポテンシャル谷を形成する第2導電型の蓄積領域を更に備え、

前記信号電荷の転送時において、前記埋込領域から前記蓄積領域へ向かい次第に電位が下がる電位勾配を形成し、前記信号電荷を前記埋込領域から前記蓄積領域へ転送することを特徴とする請求項9に記載の固体撮像装置。

【請求項11】

前記読み出し領域が、前記埋込領域の内部、前記埋込領域と連続、又は前記埋込領域と少なくとも一部を重複して設けられ、

前記読み出し領域を囲んで前記読み出し領域に連続して設けられ前記埋込領域の多数キャリアに対する前記埋込領域がなすポテンシャル谷の底の電位よりも深く、前記読み出し領域がなす前記多数キャリアに対するポテンシャル井戸の深さよりも浅いポテンシャル谷を形成する第2導電型の蓄積領域を更に備え、

前記信号電荷の転送時において、前記埋込領域から前記蓄積領域へ向かい次第に電位が

下がる電位勾配を形成し、前記信号電荷を前記埋込領域から前記蓄積領域へ転送することを特徴とする請求項 9 に記載の固体撮像装置。

【請求項 12】

前記蓄積領域が前記埋込領域よりも高不純物密度であることを特徴とする請求項 10 又は 11 に記載の固体撮像装置。

【請求項 13】

前記読み出し領域が、前記埋込領域の内部、前記埋込領域と連続、又は前記埋込領域と少なくとも一部を重複して設けられ、

前記信号電荷の転送時に、前記埋込領域から前記読み出し領域へ向かい次第に電位が下がる電位勾配に沿って、前記信号電荷が前記埋込領域から前記読み出し領域へ直接転送されることを特徴とする請求項 9 に記載の固体撮像装置。

【請求項 14】

前記電荷が前記埋込領域から排出される時の、電荷流入面の主面となる排出領域の端部が、平面パターン上前記埋込領域の端部と平行に対峙していることを特徴とする請求項 9 ~ 13 のいずれか 1 項に記載の固体撮像装置。

【請求項 15】

前記蓄積領域の下方に、第 1 導電型で前記半導体領域よりも高不純物密度のブロック層を更に備えることを特徴とする請求項 10 ~ 13 のいずれか 1 項に記載の固体撮像装置。

【請求項 16】

前記排出領域の一部と前記読み出し領域の周囲を少なくとも囲む第 1 導電型のウェル領域を更に備え、

前記読み出し領域の少なくとも一部が、平面パターン上、前記ウェル領域の内部に含まれことを特徴とする請求項 13 に記載の固体撮像装置。

【請求項 17】

前記読み出し領域が、前記画素にそれぞれ設けられた読み出しトランジスタのゲート電極に接続されることを特徴とする請求項 10 ~ 16 のいずれか 1 項に記載の固体撮像装置。

【請求項 18】

前記読み出し領域が、リセットトランジスタのソース電極をなす、又は前記ソース電極に接続されることを特徴とする請求項 17 に記載の固体撮像装置。

## 【 国際調査報告 】

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2010/067452

<b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b> H04N5/335(2006.01)i, H01L27/146(2006.01)i		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
<b>B. FIELDS SEARCHED</b>		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) H04N5/335, H01L27/146		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2010 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2010 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2010		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
<b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b>		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2008-103647 A (National University Corporation Shizuoka University), 01 May 2008 (01.05.2008), paragraphs [0065] to [0067]; fig. 1, 17 to 18 (Family: none)	1-2, 4, 6-7, 9-10, 12, 14-15, 17-18 3, 5, 8, 11, 13, 16
A		
Y	JP 2008-252814 A (National University Corporation Shizuoka University), 16 October 2008 (16.10.2008), paragraphs [0080] to [0099]; fig. 20, 22 (Family: none)	1-2, 4, 6-7, 9-10, 12, 14-15, 17-18 3, 5, 8, 11, 13, 16
A		
Y	JP 2001-326341 A (NEC Corp.), 22 November 2001 (22.11.2001), paragraphs [0021] to [0023]; fig. 1 & US 2001/0040210 A1	7, 15
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C.		<input type="checkbox"/> See patent family annex.
* Special categories of cited documents:		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance		"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date		"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)		"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means		
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		
Date of the actual completion of the international search 29 October, 2010 (29.10.10)	Date of mailing of the international search report 09 November, 2010 (09.11.10)	
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer	
Facsimile No.	Telephone No.	

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 0 / 0 6 7 4 5 2									
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. H04N5/335 (2006.01)i, H01L27/146 (2006.01)i											
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. H04N5/335, H01L27/146											
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922-1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971-2010年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996-2010年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994-2010年</td> </tr> </table>				日本国実用新案公報	1922-1996年	日本国公開実用新案公報	1971-2010年	日本国実用新案登録公報	1996-2010年	日本国登録実用新案公報	1994-2010年
日本国実用新案公報	1922-1996年										
日本国公開実用新案公報	1971-2010年										
日本国実用新案登録公報	1996-2010年										
日本国登録実用新案公報	1994-2010年										
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)											
C. 関連すると認められる文献											
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号									
Y  A	JP 2008-103647 A (国立大学法人静岡大学) 2008.05.01, 段落【0065】 - 【0067】, 図 1, 17-18 (ファミリーなし)	1-2, 4, 6-7, 9-10, 12, 14-15, 17-18 3, 5, 8, 11, 13, 16									
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。											
* 引用文献のカテゴリー		の日の後に公表された文献									
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの		「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの									
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの		「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの									
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)		「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの									
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献		「&」同一パテントファミリー文献									
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願											
国際調査を完了した日 29.10.2010		国際調査報告の発送日 09.11.2010									
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 鈴木 肇	5 P 9847								
		電話番号 03-3581-1101	内線 3581								

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP2010/067452

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 2008-252814 A (国立大学法人静岡大学) 2008.10.16, 段落【0080】 - 【0099】, 図 20, 22 (ファミリーなし)	1-2, 4, 6-7, 9- 10, 12, 14-15, 17-18
A		3, 5, 8, 11, 13, 16
Y	JP 2001-326341 A (日本電気株式会社) 2001.11.22, 段落【0021】 - 【0023】, 図 1 & US 2001/0040210 A1	7, 15

## フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

(出願人による申告)平成20年度、文部科学省、地域科学技術振興事業委託事業、産業技術力強化法第19条の適用を受ける特許出願

Fターム(参考) 4M118 AB01 BA14 CA04 CA18 CA20 EA01 EA14 FA06 FA14 FA24  
FA33  
5C024 AX01 CX37 CY16 CY17 GX03 GX06 GY31 HX12 HX41

(注)この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。